

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-184033

(P2016-184033A)

(43) 公開日 平成28年10月20日(2016.10.20)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G03G 5/06 (2006.01)	G03G 5/06 313	2H068
G03G 5/05 (2006.01)	G03G 5/06 312	
	G03G 5/05 101	
	G03G 5/05 104B	
	G03G 5/06 372	
審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 62 頁)		

(21) 出願番号 特願2015-63302 (P2015-63302)
 (22) 出願日 平成27年3月25日 (2015.3.25)

(71) 出願人 000005496
 富士ゼロックス株式会社
 東京都港区赤坂九丁目7番3号
 (74) 代理人 110001519
 特許業務法人太陽国際特許事務所
 (72) 発明者 川崎 晃弘
 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
 ゼロックス株式会社内
 (72) 発明者 宮本 昌彦
 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
 ゼロックス株式会社内
 (72) 発明者 杉浦 聡哉
 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
 ゼロックス株式会社内

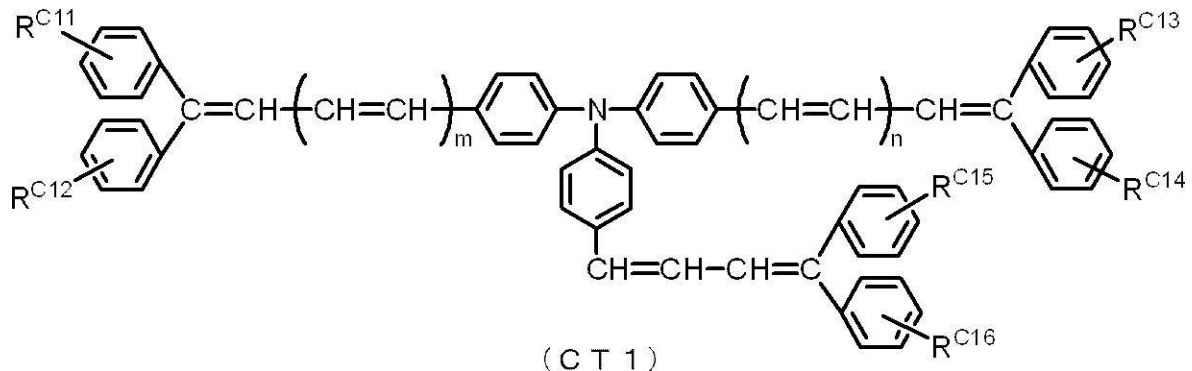
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置およびプロセスカートリッジ

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置を提供する。

【解決手段】式CT1の電荷輸送材料と、特定構造の電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤及びベンゾフェノン系紫外線吸収剤の少なくとも1種と、を含む感光層を有する電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、を備える画像形成装置。



10

【選択図】 なし

20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料と、下記一般式（CT1）で示される電荷輸送材料と、下記一般式（CT2）で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種と、を含む感光層とを有する電子写真感光体と、

直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して、前記電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、

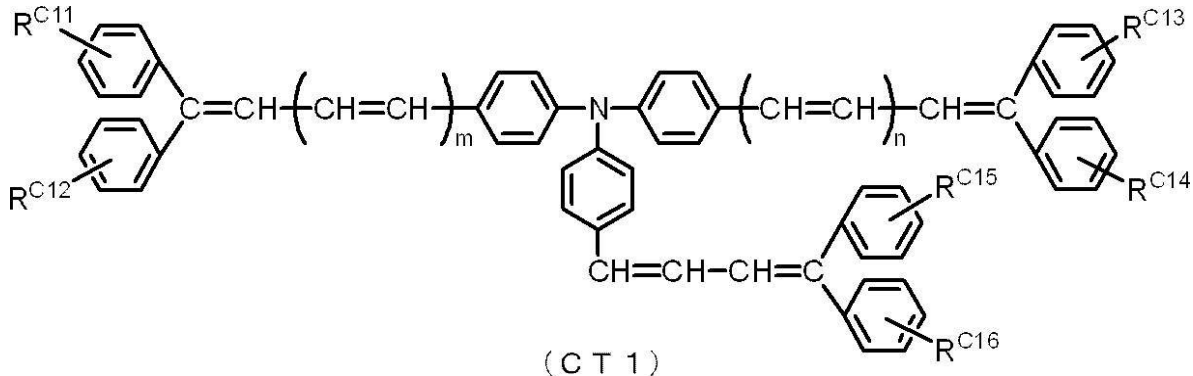
帯電した前記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、

トナーを含む現像剤により、前記電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像してトナー像を形成する現像手段と、

前記トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、

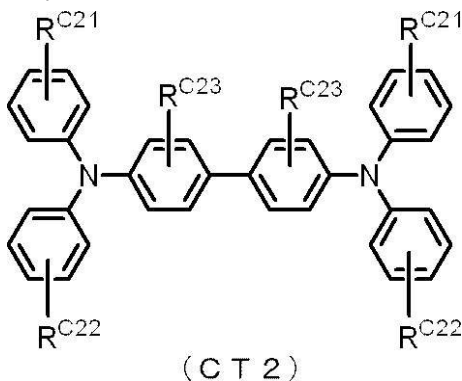
を備える画像形成装置。

【化 1】



（一般式（CT1）中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上20以下のアルキル基、炭素数1以上20以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上30以下のアリール基を表し、隣接する2つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。 n 及び m は、各々独立に、0、1又は2を表す。）

【化 2】



（一般式（CT2）中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上10以下のアリール基を表す。）

【請求項 2】

前記一般式（CT1）で示される電荷輸送材料において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、 m 及び n が1を表す請求項 1

に記載の画像形成装置。

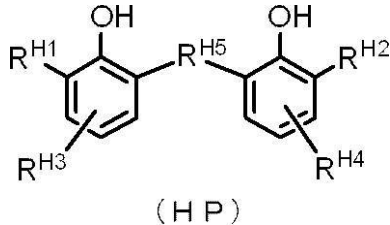
【請求項 3】

前記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料において、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す請求項 1 又は請求項 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4】

前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、下記一般式 (HP) で示される酸化防止剤である請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【化 3】



10

(一般式 (HP) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基を表す。 R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す。 R^{H5} は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基を表す。)

20

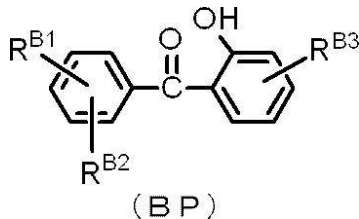
【請求項 5】

前記一般式 (HP) で示される酸化防止剤において、 R^{H1} 、及び R^{H2} が tert-ブチル基を表す請求項 4 に記載の画像形成装置。

【請求項 6】

前記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、下記一般式 (BP) で示される紫外線吸収剤である請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【化 4】



30

(一般式 (BP) 中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

【請求項 7】

前記一般式 (BP) で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤において、 R^{B1} 、及び R^{B2} が水素原子を表し、 R^{B3} が炭素数 1 以上 4 以下のアルコキシ基を表す請求項 6 に記載の画像形成装置。

40

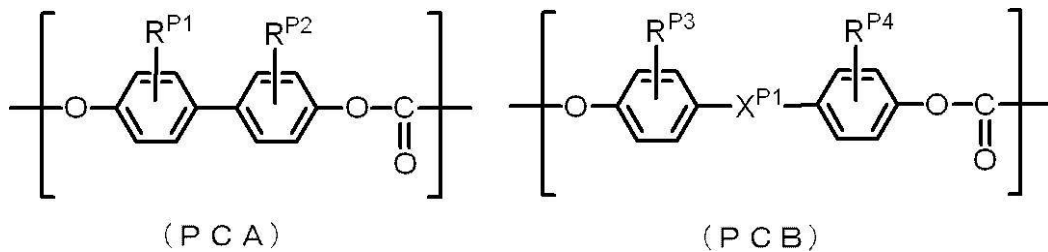
【請求項 8】

前記電荷発生材料が、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料である請求項 1 ~ 請求項 7 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 9】

前記ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が、下記一般式 (PCA) で示される構造単位と、下記一般式 (PCB) で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂である請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【化 5】



(一般式 (PCA) 及び (PCB) 中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基、炭素数 5 以上 7 以下のシクロアルキル基、又は、炭素数 6 以上 12 以下のアリール基を表す。 X^{P1} は、フェニレン基、ピフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を表す。)

【請求項 10】

前記感光層が、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤と、を更に含む請求項 1 ~ 請求項 9 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

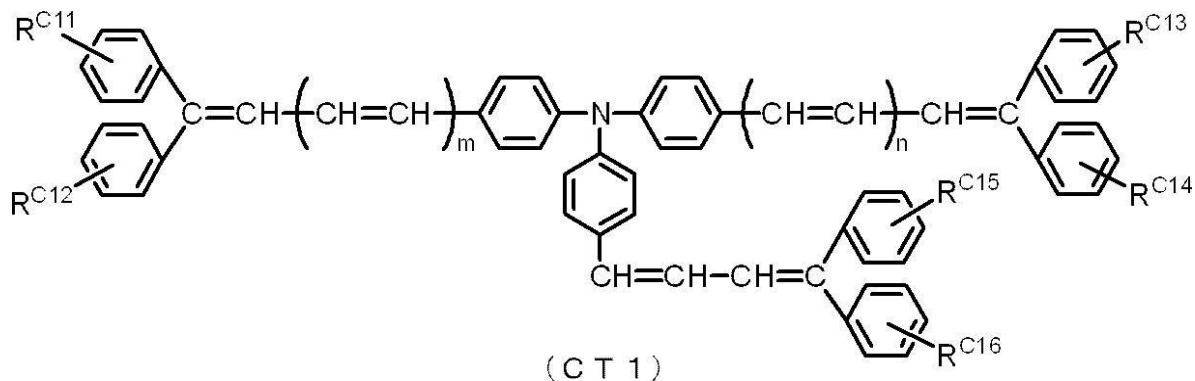
【請求項 11】

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料と、下記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、下記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、分子量 300 以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種と、を含む感光層とを有する電子写真感光体と、

直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して、前記電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、を備え、

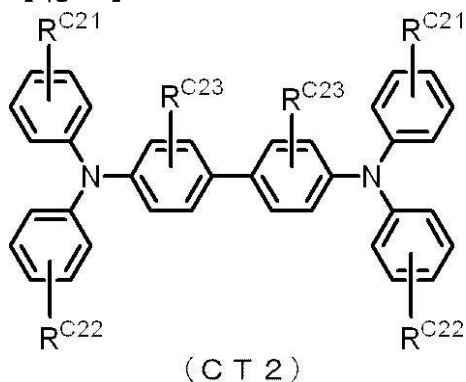
画像形成装置に着脱するプロセスカートリッジ。

【化 6】



(一般式 (CT1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。 n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。)

【化 7】



10

(一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、画像形成装置およびプロセスカートリッジに関する。

20

【背景技術】

【0002】

従来、電子写真方式の画像形成装置としては、電子写真感光体を用いて帯電、静電潜像形成、現像、転写、クリーニング等の工程を順次行う装置が広く知られている。

【0003】

電子写真感光体としては、アルミニウム等の導電性を有する基体上に、電荷を発生する電荷発生層と、電荷を輸送する電荷輸送層を積層する機能分離型の感光体、又は、電荷を発生する機能と電荷を輸送する機能を同一の層が果たす単層型感光体が知られている。

【0004】

例えば、特許文献 1 には、例えば、特許文献 1 には、電荷輸送層に、ブタジエンー量体系電荷輸送材料とヒンダードフェノール系酸化防止剤とヒンダードアミン系酸化防止剤とを含有する電子写真感光体が開示されている。

30

特許文献 2 には、感光層に、ブタジエン三量体系電荷輸送材料とフェノール系酸化防止剤とベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤とを含有する電子写真感光体が開示されている。

特許文献 3 には、最表面層に、ブタジエン系電荷輸送材料とヒンダードフェノール系酸化防止剤とを含有することを特徴とする感光体が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特開平 7-261414 号公報

【特許文献 2】特開 2010-211057 号公報

40

【特許文献 3】特開 2012-047959 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明の課題は、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、静電

50

潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置の場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記課題は、以下の手段により解決される。

【0008】

請求項1に係る発明は、

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料と、下記一般式(CT1)で示される電荷輸送材料と、下記一般式(CT2)で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種と、を含む感光層とを有する電子写真感光体と、

直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して、前記電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、

帯電した前記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、

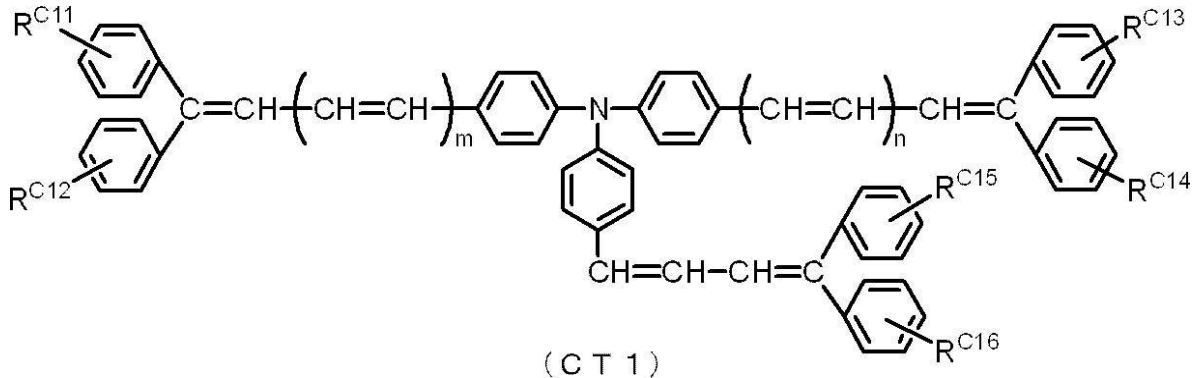
トナーを含む現像剤により、前記電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像してトナー像を形成する現像手段と、

前記トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、

を備える画像形成装置である。

【0009】

【化1】

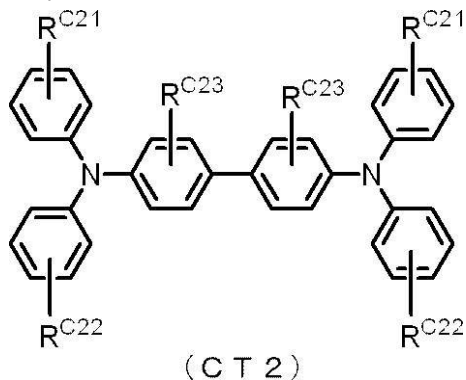


【0010】

(一般式(CT1)中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上20以下のアルキル基、炭素数1以上20以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上30以下のアリアル基を表し、隣接する2つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。 n 及び m は、各々独立に、0、1又は2を表す。)

【0011】

【化 2】



10

【0012】

(一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

【0013】

請求項 2 に係る発明は、

前記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、 m 及び n が 1 を表す請求項 1 に記載の画像形成装置である。

20

【0014】

請求項 3 に係る発明は、

前記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料において、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す請求項 1 又は請求項 2 に記載の画像形成装置である。

【0015】

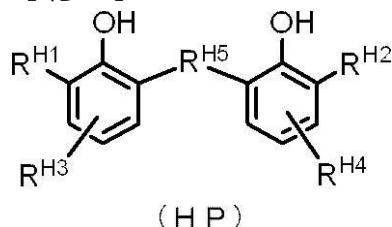
請求項 4 に係る発明は、

前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、下記一般式 (HP) で示される酸化防止剤である請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置である。

【0016】

30

【化 3】



【0017】

(一般式 (HP) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基を表す。 R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す。 R^{H5} は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基を表す。)

40

【0018】

請求項 5 に係る発明は、

前記一般式 (HP) で示される酸化防止剤において、 R^{H1} 、及び R^{H2} が *tert*-ブチル基を表す請求項 4 に記載の画像形成装置である。

【0019】

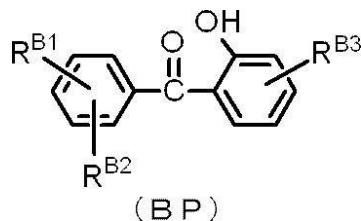
請求項 6 に係る発明は、

前記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、下記一般式 (BP) で示される紫外線吸収剤である請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置である。

50

【 0 0 2 0 】

【 化 4 】



【 0 0 2 1 】

(一般式 (BP) 中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

10

【 0 0 2 2 】

請求項 7 に係る発明は、

前記一般式 (BP) で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤において、 R^{B1} 、及び R^{B2} が水素原子を表し、 R^{B3} が炭素数 1 以上 4 以下のアルコキシ基を表す請求項 6 に記載の画像形成装置である。

【 0 0 2 3 】

請求項 8 に係る発明は、

前記電荷発生材料が、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料である請求項 1 ~ 請求項 7 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置である。

20

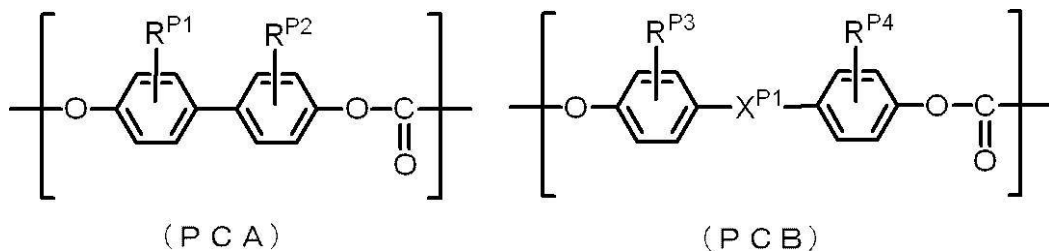
【 0 0 2 4 】

請求項 9 に係る発明は、

前記ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が、下記一般式 (PCA) で示される構造単位と、下記一般式 (PCB) で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂である請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置である。

【 0 0 2 5 】

【 化 5 】



30

【 0 0 2 6 】

(一般式 (PCA) 及び (PCB) 中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基、炭素数 5 以上 7 以下のシクロアルキル基、又は、炭素数 6 以上 12 以下のアリール基を表す。 X^{P1} は、フェニレン基、ビフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を表す。)

40

【 0 0 2 7 】

請求項 10 に係る発明は、

前記感光層が、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤と、を更に含む請求項 1 ~ 請求項 9 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置である。

【 0 0 2 8 】

請求項 11 に係る発明は、

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料と、下記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、下記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂

50

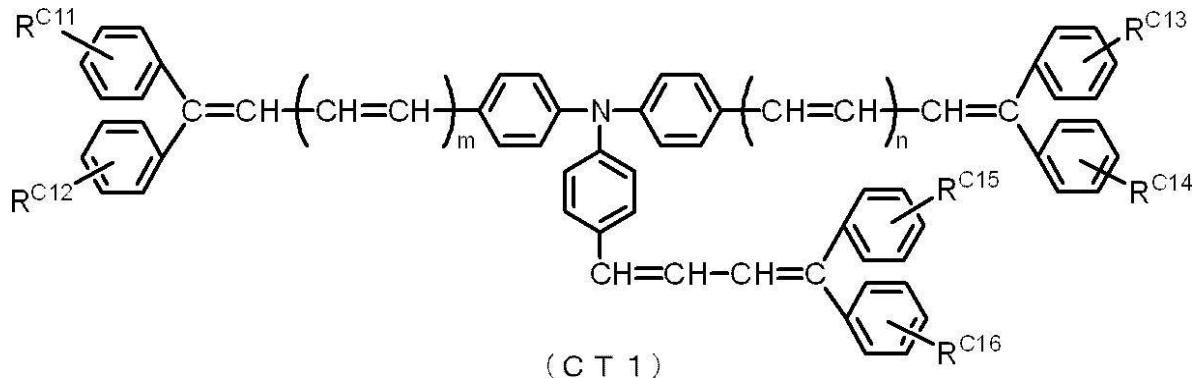
脂と、分子量 300 以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種と、を含む感光層とを有する電子写真感光体と、

直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して、前記電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、を備え、

画像形成装置に着脱するプロセスカートリッジである。

【0029】

【化 6】



10

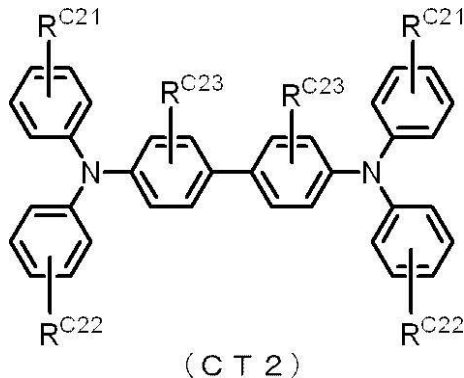
【0030】

(一般式 (CT1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。)

20

【0031】

【化 7】



30

【0032】

(一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

40

【発明の効果】

【0033】

請求項 1 に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置の場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感

50

光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

請求項 2 に係る発明によれば、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料が、例示化合物 (CT1-1) である電子写真感光体を備える場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

請求項 3 に係る発明によれば、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料が、例示化合物 (CT2-1) である電子写真感光体を備える場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0034】

請求項 4、又は 5 に係る発明によれば、酸化防止剤が、構造式 (CAO-1) で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤である電子写真感光体を備える場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0035】

請求項 6、又は 7 に係る発明によれば、紫外線吸収剤が、構造式 (CUA-1) で示されるベンゾエート系紫外線吸収剤である電子写真感光体を備える場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0036】

請求項 8 に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置の場合に比べ、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料を感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0037】

請求項 9 に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置の場合に比べ、前記一般式 (PCA) で示される構造単位と、前記一般式 (PCB) で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂を感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0038】

請求項 10 に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置の場合に

10

20

30

40

50

比べ、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0039】

請求項11に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式(CT1)で示される電荷輸送材料と、一般式(CT2)で示される電荷輸送材料と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種のみを含む電子写真感光体と、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して電子写真感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段とを備えるプロセスカートリッジの場合に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制したプロセスカートリッジが提供される。

10

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図1】本実施形態に係る画像形成装置の一例を示す概略構成図である。

【図2】本実施形態に係る電子写真感光体の層構成の一例を示す概略部分断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0041】

以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、図面中、同様の機能を有する要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。

20

【0042】

< 画像形成装置 >

本実施形態に係る画像形成装置は、導電性基体上に、電荷発生材料と、下記一般式(CT1)で示される電荷輸送材料(以下「ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)」とも称する)と、下記一般式(CT2)で示される電荷輸送材料(以下「ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)」とも称する)と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤(以下単に「ヒンダードフェノール系酸化防止剤」とも称する)およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種と、を含む感光層を有する電子写真感光体(以下、「感光体」とも称する)を備える。

30

そして、本実施形態に係る画像形成装置は、更に、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して、感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段と、帯電した感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、トナーを含む現像剤により、感光体の表面に形成された静電潜像を現像してトナー像を形成する現像手段と、トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、を備える。

【0043】

本実施形態に係る画像形成装置は、上記構成により、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。その理由は、以下に示すように推察される。

40

【0044】

まず、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)は、電荷移動度が高く、電荷輸送能の高い感光層(又は電荷輸送層)を得る上で適している。一方で、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)は、溶剤に対する溶解性が低い性質がある。このため、高い電荷輸送能を有する感光層を得るためには、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)と共に、電荷移動度が比較的高く、溶剤に対する溶解性が高いベンジジン系電荷輸送材料(CT2)を併用することがよい。

【0045】

しかし、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)及びベンジジン系電荷輸送材料(CT2)を共に含む感光層を有する感光体を備えた画像形成装置を使用し、同一画像を連続出力

50

(例えば3000枚連続出力)した後に、例えば、全面ハーフトーン画像を出力すると、同一画像出力により連続露光された部分の感光体の表面電位が低下し、濃度が濃くなる「焼付きゴースト」と称する画像欠陥(ポジゴースト)が発生してしまうことがある。

また、感光体を交換するとき等に、感光体が室内光又は太陽光等に光暴露されると、光暴露された部分の感光体の帯電性が低下し、その後、全面ハーフトーン画像を出力すると、光暴露された部分の画像濃度が濃く浮き出る「光疲労」と称する画像欠陥が生じてしまう。

【0046】

「焼付きゴースト」及び「光疲労」と称される画像欠陥が生じる原因は、同一画像の連続出力および光暴露により、感光層中の電荷発生材料から電荷輸送材料への電荷の注入、および電荷輸送材料間の電荷の移動に預かる電子の非局在化領域において、電子が励起されやすい状態が生じることにより発生するためと考えられる。つまり、この画像欠陥は、電荷発生および電荷注入が活性化されることにより、同一画像の連続出力により連続して露光された領域、および光暴露された領域の帯電電位が低下し、画像の濃度上昇が生じることにより発生すると考えられる。

そして、この帯電電位の低下による画像の濃度上昇は、感光層がブタジエン系電荷輸送材料(CT1)及びベンジジン系電荷輸送材料(CT2)を共に含有する場合に、特に顕著となる。これは、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)が構造上高い電荷輸送能力を有するが故に、分子内の電子の非局在化領域が大きく、ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)及び電荷発生材料との間で相互作用を生じ、同一画像の連続出力および光暴露によって、帯電電位の低下が顕著に生じるためと考えられる。

【0047】

更に、結着樹脂として、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂(以下「BPポリカーボネート樹脂」とも称する)を含む感光層は、耐摩耗性が向上し、感光体の長寿命化が図れる。しかし、結着樹脂として、BPポリカーボネート樹脂を含む感光層を有する感光体でも、特に、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じる。BPポリカーボネート樹脂のビフェニル骨格のベンゼン環は、電荷輸送材料と相互作用することにより、電荷のトラップサイト(電荷が蓄積され易い領域)として働き易くなると考えられる。この電荷のトラップサイトにより、感光層中で電荷が過剰に蓄積されると、帯電後、感光体の表面に蓄積された電荷と相殺されるため、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じると考えられる。

【0048】

また、感光体を帯電させる帯電手段として、接触型又は近接型の帯電手段を採用した場合、放電生成物等の発生が抑制され、且つ装置の小型化及び低価格化が図れる。また、接触型又は近接型の帯電手段の中でも、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して感光体を帯電させる帯電方式(以下、「重畳電圧印加方式」とも称する)を採用することで、帯電の均一性が得られやすくなる。しかし、重畳電圧印加方式の接触型又は近接型の帯電手段は、非接触型の帯電手段(例えば、スコロトロン帯電器)に比べ、帯電電位の低下のしやすさ及び履歴の残りやすさの点で帯電性能が劣る傾向がある。このため、重畳電圧印加方式の接触型又は近接型の帯電手段を採用した場合、「焼付きゴースト」及び「光疲労」がより顕著に生じやすくなる。

【0049】

これに対して、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)及びベンジジン系電荷輸送材料(CT2)と、BPポリカーボネート樹脂とを共に含む感光層に、更に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤を含有させると、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が抑制される。これは、ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、電子の非局在化領域との間で電荷の授受等の相互作用を生じさせ、同一画像の連続出力および光暴露による電子の非局在化領域において、電子のエネルギー状態の変化を抑制すると考えられるためである。そして、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量を300以上とすると、感光層を形成するときの乾燥工程において、ヒンダードフェノール系酸化防止剤が揮発すること

が抑制される。つまり、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量を300以上とすると、感光層中に上記機能を発現する量でヒンダードフェノール系酸化防止剤が残留すると考えられる。

【0050】

一方、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）及びベンジジン系電荷輸送材料（CT2）と、BPポリカーボネート樹脂とを共に含む感光層に、更に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤を含有させても、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が抑制される。これは、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、同一画像の連続出力および光暴露によって、感光層に受ける光エネルギーを吸収し、電子の非局在化領域において、電子のエネルギー状態の変化を抑制するためと考えられる。

10

【0051】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、BPポリカーボネート樹脂のビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料とに作用し、ビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料との相互作用による電荷のトラップサイトの形成が抑制されると考えられる。このため、ビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料との相互作用による電荷のトラップサイトに起因して生じる感光層中の電荷の過剰な蓄積が抑制されると考えられる。

【0052】

更に、本実施形態では、感光体を上記構成とすることにより、上述のように、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が抑制されるため、重畳電圧印加方式の接触型又は近接型の帯電手段と組み合わせて用いた場合であっても、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が生じにくくなる。

20

【0053】

以上のことから、本実施形態に係る画像形成装置は、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制すると推察される。

【0054】

そして、本実施形態に係る電子写真感光体では、結着樹脂として、BPポリカーボネート樹脂を感光層に含むため、感光層の耐摩耗性が向上し、長寿命化が実現される。

【0055】

30

また、電荷発生材料として、電荷発生効率の高いヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料を感光層に含む場合、発生する電荷量が多いため、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が顕著になり、焼付きゴースト及び光疲労が発生し易くなる。しかし、本実施形態に係る画像形成装置では、ヒドロキシガリウムフタロシアニンを感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。

【0056】

更に、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含む場合、感光層の耐摩耗性が向上し、感光体の長寿命化が図れる。一方で、フッ素含有分散剤を感光層に含むと、フッ素含有分散剤が電荷のトラップサイト（電荷が蓄積され易い領域）として働き易くなると考えられる。この電荷のトラップサイトにより、感光層中で電荷が過剰に蓄積されると、帯電後、感光体の表面に蓄積された電荷と相殺されるため、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じると考えられる。しかし、本実施形態に係る画像形成装置では、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。

40

【0057】

以下、図面を参照しつつ、本実施形態に係る画像形成装置について詳細に説明する。

【0058】

図1は、本実施形態に係る画像形成装置の構成の一例を示す概略構成図である。

50

図 1 に示すように、本実施形態に係る画像形成装置 10 には、例えば、電子写真感光体 7 が設けられている。感光体 7 は、円柱状とされ、駆動モータ 27（駆動部の一例）にギア等の駆動力伝搬部材（不図示）を介して連結されており、当該駆動モータ 27 により、回転駆動（図 1 中の矢印 A 方向）される。

【0059】

感光体 7（像保持体の一例）の周辺には、例えば、帯電装置 15（帯電手段の一例）、静電潜像形成装置 16（静電潜像形成手段の一例）、現像装置 18（現像手段の一例）、転写装置 31（転写手段の一例）、清掃装置（クリーニング装置）22（清掃手段の一例）、及び除電装置 24（除電手段の一例）が、感光体 7 の回転方向に沿って順に配設されている。そして、本実施形態に係る画像形成装置 10 には、定着装置 26 も配設されている。さらに、画像形成装置 10 内の各装置及び各部材と接続され、各装置及び各部材の動作を制御する制御装置 36 も備えている。

10

【0060】

感光体 7 は、例えば、導電性基体と、この導電性基体上に形成された下引層と、この下引層の上に形成された感光層と、から構成されている。この感光層は、電荷発生層と電荷輸送層との 2 層構造であってもよい。また、感光層は、最表面に保護層を設けた構成であってもよく、下引層は形成されていない構成であってもよい。

なお、感光体 7 の詳細な構成については、後述する。

【0061】

以下、画像形成装置 10 の各部の詳細について説明する。

20

【0062】

（帯電装置）

本実施形態における帯電装置 15（帯電手段の一例）は、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して、感光体 7 を帯電させる接触型又は近接型の帯電装置である。

接触型又は近接型の帯電装置 15 とは、感光体 7 の表面に接触又は近接して配置され、感光体 7 の表面を帯電させる帯電装置をいう。ここで、帯電装置 15 を近接して配置するとは、例えば、帯電装置 15（導電性部材（帯電部材 14））を感光体 7 の表面から 1 μ m 以上 200 μ m 以下の範囲で離間して配置することを示す。

【0063】

本実施形態では、感光体 7 に電圧を印加する方式として、重畳電圧印加方式を採用する。重畳電圧印加方式とは、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して感光体 7 の表面を帯電させる方式をいう。

30

帯電条件としては、交流電圧のピーク間電圧は、好ましくは 400 V 以上 3000 V 以下、より好ましくは 800 V 以上 2800 V 以下、さらに好ましくは 1200 V 以上 2800 V 以下である。また交流電圧の周波数は、好ましくは 50 Hz 以上 20000 Hz 以下、より好ましくは 100 Hz 以上 5000 Hz 以下である。また、交流電圧に重畳する直流電圧としては、好ましくは正又は負で 50 V 以上 2000 V 以下、より好ましくは正又は負で 100 V 以上 1500 V 以下である。

電圧印加方式（重畳電圧印加方式、交流電圧印加方式、又は直流電圧印加方式）の選択は、市場のニーズ（維持費、価格、除電装置の有無、規模等）に応じて適宜選択される。例えば、重畳電圧印加方式を採用すると、帯電の均一性が得られやすくなる。

40

【0064】

帯電装置 15 は、例えば、感光体 7 の表面を帯電させる帯電部材 14 に、帯電電圧を印加する電源 28（帯電部材用の電圧印加部の一例）を含んで構成されている。電源 28 は、帯電部材 14 に電氣的に接続されている。本実施形態における電源 28 は、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加する電源である。

【0065】

帯電部材 14 は、感光体 7 の表面に接触して又は近接して設けられている。帯電部材 14 としては、例えば、帯電ローラ、帯電ブラシ、帯電フィルム、帯電ゴムブレード、帯電チューブ等の導電性又は半導電性部材を感光体 7 の表面に接触して設ける接触型帯電器、

50

前記導電性又は半導電性部材を感光体 7 の表面と離間して設ける近接型帯電器が挙げられる。

【0066】

本実施形態においては、帯電特性・汎用性の点から、接触型帯電器又は近接型帯電器として、帯電ロールを用いることが好ましい。

帯電ロールとしては、例えば、導電性支持体（シャフト）上に、導電性弾性層と、必要に応じて、表面層とが順次形成されたものである。

【0067】

帯電ロールの導電性支持体（シャフト）の材質としては、快削鋼、ステンレス鋼等が使用され、摺動性などの用途に応じ材質及び表面処理方法は適時選択され、導電性を有さない材質についてはメッキ処理など一般的な処理により加工され導電化処理が行われていてもよい。

10

【0068】

帯電ロールの導電性弾性層は、例えば、弾性を有するゴム等の弾性材料、導電性弾性層の抵抗を調整するカーボンブラックやイオン導電材等の導電剤、必要に応じて軟化剤、可塑剤、硬化剤、加硫剤、加硫促進剤、老化防止剤、シリカ及び炭酸カルシウム等の充填剤等、通常ゴムに添加され得る材料を加えてもよい。通常ゴムに添加される材料を添加した混合物を、導電性支持体の周面に被覆することにより形成される。

導電性弾性層は、抵抗値の調整を目的とした導電剤として、カーボンブラック、導電性金属酸化物粒子、イオン導電剤等の材料であって、電子及びイオンの少なくとも一方を電荷キャリアとして電気伝導する材料を分散したもの等を用いることができる。

20

また、導電性弾性層は発泡体であっても構わない。

【0069】

また、帯電ロールの表面層は、トナー等の異物による汚染の防止のためなどに形成しているものである。

表面層の材料としては、樹脂、ゴム等の何れを用いてもよく特に限定するものではなく、例えば、ポリエステル、ポリイミド、共重合ナイロン、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルブチラル、エチレンテトラフルオロエチレン共重合体、メラミン樹脂、フッ素ゴム、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、セルロース、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体等を挙げることができる。

30

【0070】

また、表面層には、導電性弾性層に用いたものと同様の導電剤を含有させ、抵抗値を調整してもよい。更に、表面層には、フッ素系又はシリコーン系の樹脂、絶縁性の粒子等を添加してもよい。

【0071】

帯電装置 15（電源 28 を含む）は、例えば、画像形成装置 10 に設けられた制御装置 36 に電氣的に接続されており、制御装置 36 により駆動制御されて、帯電部材 14 に帯電電圧を印加する。電源 28 から帯電電圧を印加された帯電部材 14 は、印加された帯電電圧に応じた帯電電位に、感光体 7 を帯電させる。このため、電源 28 から印加される帯電電圧が調整されることで、感光体 7 は、異なる帯電電位に帯電される。

40

【0072】

（静電潜像形成装置）

静電潜像形成装置（露光装置）16（静電潜像形成手段の一例）は、帯電された感光体 7 の表面に静電潜像を形成する。

具体的には、例えば、静電潜像形成装置 16 は、画像形成装置 10 に設けられた制御装置 36 に電氣的に接続されており、制御装置 36 により駆動制御されて、帯電部材 14 により帯電された感光体 7 の表面に、形成する対象となる画像の画像情報に基づいて変調された光 L を露光する。そして、感光体 7 上に画像情報の画像に応じた静電潜像を形成する。

50

【 0 0 7 3 】

静電潜像形成装置 1 6 としては、例えば、半導体レーザ光、発光ダイオード（LED：ライト・エミッティング・ダイオード）光、液晶シャッタ光等の光を像様に露光する光源を持つ光学系機器等の露光装置が挙げられる。光源の波長は電子写真感光体 7 の分光感度領域にあるものがよい。半導体レーザの波長としては、例えば、780nm 前後に発振波長を有する近赤外がよい。しかし、この波長に限定されず、600nm 台の発振波長レーザや青色レーザとして400nm以上450nm以下に発振波長を有するレーザも利用してもよい。また、静電潜像形成装置 1 6 としては、例えばカラー画像形成のためにはマルチビーム出力する形式の面発光型のレーザ光源も有効である。

【 0 0 7 4 】

（現像装置）

現像装置 1 8 は、例えば、静電潜像形成装置 1 6 による光 L の照射位置より感光体 7 の回転方向下流側に設けられている。現像装置 1 8 内には、現像剤を収容する収容部が設けられている。

なお、現像装置 1 8 に収容される現像剤としては、トナー単独の一成分系現像剤であってもよいし、トナーとキャリアとを含む二成分系現像剤であってもよい。また、現像剤は、磁性であってもよいし、非磁性であってもよい。

現像装置 1 8 は、例えば、トナーを含む現像剤により、感光体 7 の表面に形成された静電潜像を現像する現像部材 1 8 A と、現像部材 1 8 A に現像電圧を印加する電源 3 2（現像部材用の電圧印加部の一例）と、を含んで構成されている。この現像部材 1 8 A は、例えば、電源 3 2 に電氣的に接続されている。

【 0 0 7 5 】

現像装置 1 8 の現像部材 1 8 A としては、現像剤の種類に応じて選択されるが、例えば、磁石が内蔵された現像スリーブを有する現像ロールが挙げられる。

【 0 0 7 6 】

現像装置 1 8（電源 3 2 を含む）は、例えば、画像形成装置 1 0 に設けられた制御装置 3 6 に電氣的に接続されており、制御装置 3 6 により駆動制御されて、現像部材 1 8 A に現像電圧を印加する。電源 3 2 から現像電圧を印加された現像部材 1 8 A は、印加された現像電圧に応じた現像電位に帯電される。

そして、現像電位に帯電された現像部材 1 8 A は、例えば、現像装置 1 8 内に収容された現像剤を表面に保持して、現像剤に含まれるトナーを現像装置 1 8 内から感光体 7 の表面へと供給する。

【 0 0 7 7 】

感光体 7 上に供給されたトナーは、例えば、感光体 7 上の静電潜像に静電力により付着する。詳細には、例えば、感光体 7 と現像部材 1 8 A との向かい合う領域における電位差、すなわち、この領域における感光体 7 の表面の電位と現像部材 1 8 A の現像電位との電位差によって、現像剤に含まれるトナーが感光体 7 の静電潜像の形成された領域に供給され、現像剤にキャリアが含まれている場合には、キャリアは現像部材 1 8 A に保持されたまま現像装置 1 8 内に戻る。

これにより、例えば、感光体 7 上の静電潜像は、現像部材 1 8 A から供給されたトナーによって現像されて、感光体 7 上には、静電潜像に応じたトナー像が形成される。

【 0 0 7 8 】

（転写装置）

転写装置 3 1（転写手段の一例）は、例えば、現像部材 1 8 A の配設位置より感光体 7 の回転方向下流側に設けられている。

転写装置 3 1 は、例えば、感光体 7 の表面に形成されたトナー画像を記録媒体 P（被転写体の一例）へ転写する転写部材 2 0 と、転写部材 2 0 に転写電圧を印加する電源 3 0（転写部材用の電圧印加部の一例）と、を含んで構成されている。転写部材 2 0 は、例えば、円柱状とされており、図 1 中矢印 C 方向に回転され、感光体 7 との間で記録媒体 P を挟んで搬送する。転写部材 2 0 は、例えば、電源 3 0 に電氣的に接続されている。

10

20

30

40

50

【 0 0 7 9 】

転写装置 3 1 の転写部材 2 0 としては、例えば、ベルト、ローラ、フィルム、ゴムブレード等を用いた接触型転写帯電器、コロナ放電を利用したスコロトロン転写帯電器やコロトロン転写帯電器等のそれ自体公知の非接触型転写帯電器が挙げられる。

【 0 0 8 0 】

転写装置 3 1 (電源 3 0 を含む) は、例えば、画像形成装置 1 0 に設けられた制御装置 3 6 に電氣的に接続されており、制御装置 3 6 により駆動制御されて、転写部材 2 0 に転写電圧を印加する。電源 3 0 から転写電圧を印加された転写部材 2 0 は、印加された転写電圧に応じた転写電位に帯電される。

【 0 0 8 1 】

転写部材 2 0 の電源 3 0 から転写部材 2 0 に、感光体 7 上に形成されたトナー像を構成するトナーとは逆極性の転写電圧が印加されると、例えば、感光体 7 と転写部材 2 0 との向かい合う領域 (図 1 中、転写領域 T 参照) には、感光体 7 上のトナー像を構成する各トナーを静電力により感光体 7 から転写部材 2 0 側へと移動させる電界強度の電界が形成される。

【 0 0 8 2 】

記録媒体 P (被転写体の一例) は、例えば、図示を省略する収容部に収容されており、この収容部から図示を省略する複数の搬送部材によって搬送経路 3 4 に沿って搬送され、感光体 7 と転写部材 2 0 との向かい合う領域である転写領域 T に到る。図 1 中に示す例では、矢印 B 方向に搬送される。転写領域 T に到達した記録媒体 P は、例えば、転写部材 2 0 に転写電圧が印加されることにより、この領域に形成された転写電界によって、感光体 7 上のトナー像が転写される。すなわち、例えば、感光体 7 の表面から記録媒体 P へのトナーの移動により、記録媒体 P 上にトナー像が転写される。

【 0 0 8 3 】

感光体 7 上のトナー像は、転写電界により記録媒体 P 上に転写される。転写電界の大きさは転写電流値に基づいて制御されている。転写電流値は、定電流制御で転写電界を印加したときに転写装置 3 1 で検出される電流値である。転写電流値は、転写電界の大きさを表す。

【 0 0 8 4 】

(清掃装置)

清掃装置 (クリーニング装置) 2 2 (清掃手段の一例) は、転写領域 T より感光体 7 の回転方向下流側に設けられている。

清掃装置 2 2 は、トナー像を記録媒体 P に転写した後に、感光体 7 に付着した付着物を除去する。

清掃装置 2 2 は、感光体 7 上の残留トナーや紙粉等の付着物を除去する。清掃装置 2 2 としては、例えば、感光体 7 に対して、予め定めた線圧で接触する清掃ブレード (クリーニングブレード) 2 2 A を有する構成等が挙げられる。清掃ブレード 2 2 A は、例えば、線圧 1 0 g / c m 以上 1 5 0 g / c m 以下で感光体 7 に接触することがよい。

【 0 0 8 5 】

(除電装置)

除電装置 2 4 (除電手段の一例) は、例えば、清掃装置 2 2 より感光体 7 の回転方向下流側に設けられている。

除電装置 2 4 は、トナー画像を転写した後、感光体 7 の表面を露光して除電する。

具体的には、例えば、除電装置 2 4 は、画像形成装置 1 0 に設けられた制御装置 3 6 に電氣的に接続されており、制御装置 3 6 により駆動制御されて、感光体 7 の全表面 (具体的には例えば画像形成領域の全面) を露光して除電する。

【 0 0 8 6 】

除電装置 2 4 としては、例えば、白色光を照射するタングステンランプ、赤色光を照射する発光ダイオード (L E D) 等の光源を有する装置が挙げられる。

【 0 0 8 7 】

(定着装置)

定着装置 2 6 (定着手段の一例) は、例えば、転写領域 T より記録媒体 P の搬送経路 3 4 の搬送方向下流側に設けられている。

定着装置 2 6 は、例えば、記録媒体 P 上に転写されたトナー像を定着する。

具体的には、例えば、定着装置 2 6 は、画像形成装置 1 0 に設けられた制御装置 3 6 に電氣的に接続されており、制御装置 3 6 により駆動制御されて、記録媒体 P 上に転写されたトナー像を熱または熱及び圧力によって記録媒体 P に定着する。

【 0 0 8 8 】

定着装置 2 6 としては、それ自体公知の定着器、例えば、熱ローラ定着器、オープン定着器等が挙げられる。

10

【 0 0 8 9 】

ここで、搬送経路 3 4 に沿って搬送されて感光体 7 と転写部材 2 0 との向かい合う領域 (転写領域 T) を通過することによりトナー像を転写された記録媒体 P は、例えば、図示を省略する搬送部材によって、さらに、搬送経路 3 4 に沿って定着装置 2 6 の設置位置に到り、記録媒体 P 上のトナー像の定着が行われる。

トナー像の定着によって画像形成された記録媒体 P は、図示を省略する複数の搬送部材によって、画像形成装置 1 0 の外部へと排出される。

なお、感光体 7 は、除電装置 2 4 による除電後、再度、帯電装置 1 5 によって帯電される。

【 0 0 9 0 】

20

(制御装置)

制御装置 3 6 は、装置全体の制御及び各種演算を行うコンピュータとして構成されている。具体的には、制御装置 3 6 は、例えば、CPU (中央処理装置 ; Central Processing Unit)、各種プログラムを記憶した ROM (Read Only Memory)、プログラムの実行時にワークエリアとして使用される RAM (Random Access Memory)、各種情報を記憶する不揮発性メモリ、及び入出力インターフェース (I / O) を備えている。CPU、ROM、RAM、不揮発性メモリ、及び I / O の各々は、バスを介して接続されている。そして、I / O には、感光体 7 (駆動モータ 2 7 を含む)、帯電装置 1 5 (電源 2 8 を含む)、静電潜像形成装置 1 6、現像装置 1 8 (電源 3 2 を含む)、転写装置 3 1 (電源 3 0 を含む)、除電装置 2 4、定着装置 2 6 等の画像形成装置 1 0 の各部が接続されている。

30

【 0 0 9 1 】

なお、CPU は、例えば、ROM や不揮発性メモリに記憶されているプログラム (例えば、画像形成シーケンスや回復シーケンス等) の制御プログラム) 実行し、画像形成装置 1 0 の各部の動作を制御する。RAM は、ワークメモリとして使用される。ROM や不揮発性メモリには、例えば、CPU が実行するプログラムや CPU の処理に必要なデータ等が記憶されている。なお、制御プログラムや各種データは、記憶部等の他の記憶装置に記憶されていてもよいし、通信部を介して外部から取得されてもよい。

【 0 0 9 2 】

また、制御装置 3 6 には、各種ドライブが接続されていてもよい。各種ドライブとしては、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD - ROM、DVD - ROM、USB メモリなどのコンピュータ読み取り可能な可搬性の記録媒体 P からデータを読み込んだり、記録媒体 P に対してデータを書き込んだりする装置が挙げられる。各種ドライブを備える場合には、可搬性の記録媒体 P に制御プログラムを記録しておいて、これに対応するドライブで読み込んで実行してもよい。

40

【 0 0 9 3 】

(画像形成動作)

画像形成装置 1 0 の画像形成動作について説明する。

まず、感光体 7 の表面が帯電装置 1 5 により帯電される。静電潜像形成装置 1 6 は、帯電された感光体 7 の表面を画像情報に基づいて露光する。これにより、感光体 7 上に画像

50

情報に応じた静電潜像が形成される。現像装置 18 では、トナーを含む現像剤により、感光体 7 の表面に形成された静電潜像が現像される。これにより、感光体 7 の表面に、トナー画像が形成される。転写装置 31 では、感光体 7 の表面に形成されたトナー画像が記録媒体 P へ転写される。記録媒体 P に転写されたトナー画像は、定着装置 26 により定着される。このように、トナーを用いて画像が形成されることにより、記録媒体 P 上には、高画質化・高解像化度を示す画像が形成される。一方、トナー画像を転写した後の感光体 7 の表面は、清掃装置 22 により清掃され、除電装置 24 により除電される。

【0094】

なお、図 1 では、転写装置 31 として、電子写真感光体の表面に形成されたトナー像を直接記録媒体 P に転写する直接転写方式の装置を例に挙げて説明したが、本実施形態に係る画像形成装置 10 は、上記構成に限らない。

本実施形態の画像形成装置 10 において、転写装置 31 としては、図示しないが、電子写真感光体の表面に形成されたトナー像を中間転写体の表面に一次転写し、中間転写体の表面に転写されたトナー像を記録媒体の表面に二次転写する中間転写方式の装置が適用されてもよい。

中間転写方式の装置の場合、例えば、表面にトナー像が転写される中間転写体と、像保持体の表面に形成されたトナー像を中間転写体の表面に一次転写する一次転写手段と、中間転写体の表面に転写されたトナー像を記録媒体の表面に二次転写する二次転写手段と、を有する構成が適用される。

【0095】

また、図 1 では、除電装置として、トナー像の転写後、帯電前に感光体の表面に除電光を照射して除電する除電手段を備える装置を例に挙げて説明したが、本実施形態に係る画像形成装置 10 は、上記構成に限らない。

本実施形態に係る画像形成装置 10 において、除電装置 24 としては、図示しないが、例えば、電子写真感光体 7 の周囲であって、転写装置 31 よりも電子写真感光体 7 の回転方向下流側で、清掃装置（クリーニング装置）22 よりも電子写真感光体の回転方向上流側に、残留したトナーの極性を揃え、クリーニングブラシで除去しやすくするための第 1 除電装置を設けた形態であってもよいし、クリーニング装置 22 よりも電子写真感光体の回転方向下流側で帯電装置 15 よりも電子写真感光体の回転方向上流側に、電子写真感光体 7 の表面を除電する第 2 除電装置を設けた形態であってもよい。また、例えば、除電装置 24 を設けない形態であってもよい。

【0096】

< プロセスカートリッジ >

本実施形態に係るプロセスカートリッジは、導電性基体上に、電荷発生材料と、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）と、ベンジジン系電荷輸送材料（CT2）と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種と、を含む感光層を有する電子写真感光体を備える。

そして、本実施形態に係るプロセスカートリッジは、更に、直流電圧に交流電圧を重ねた電圧を印加して、感光体を帯電させる接触型又は近接型の帯電手段を備え、画像形成装置に対して脱着される。

本実施形態では、例えば、画像形成装置 10 において、電子写真感光体 7 と、帯電装置 15（帯電手段の一例）とを備えるプロセスカートリッジが好適に用いられる。なお、プロセスカートリッジは、電子写真感光体及び帯電手段以外に、例えば、静電潜像形成手段、現像手段、転写手段からなる群から選択される少なくとも一つを備えてもよい。

【0097】

以下、本実施形態に係る電子写真感光体について図面を参照して説明する。

図 2 は、本実施形態に係る電子写真感光体 7A の層構成の一例を示す概略部分断面図である。図 2 に示す電子写真感光体 7A は、導電性基体 4 上に、下引層 1、電荷発生層 2 及び電荷輸送層 3 がこの順序で積層された構造を有する。そして、電荷発生層 2 及び電荷輸

10

20

30

40

50

送層 3 が感光層 5 を構成している。

なお、感光層 5 は、電荷発生層 2 と電荷輸送層 3 とを有する機能分離型の感光層であってもよいし、電荷発生層 2 と電荷輸送層 3 との機能が一体化した単層型の感光層であってもよい。機能分離型の感光層の場合、電荷発生層 2 に電荷発生剤を含み、電荷輸送層 3 に、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) と、ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) と、BP ポリカーボネート樹脂と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種と、を含む。

【0098】

また、電子写真感光体 7A は、下引層 1 が設けられていない層構成であってもよい。また、電子写真感光体 7A は、電荷輸送層 3 上に、更に保護層が設けられた層構成であってもよい。

10

【0099】

以下、電子写真感光体の各要素について説明する。なお、各要素の符号は省略して説明する。

【0100】

(導電性基体)

導電性基体としては、例えば、金属 (アルミニウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、モリブデン、バナジウム、インジウム、金、白金等) 又は合金 (ステンレス鋼等) を含む金属板、金属ドラム、及び金属ベルト等が挙げられる。また、導電性基体としては、例えば、導電性化合物 (例えば導電性ポリマー、酸化インジウム等)、金属 (例えばアルミニウム、パラジウム、金等) 又は合金を塗布、蒸着又はラミネートした紙、樹脂フィルム、ベルト等も挙げられる。ここで、「導電性」とは体積抵抗率が 10^{-13} cm 未満であることをいう。

20

【0101】

導電性基体の表面は、電子写真感光体がレーザプリンタに使用される場合、レーザ光を照射する際に生じる干渉縞を抑制する目的で、中心線平均粗さ Ra で $0.04\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下に粗面化されていることが好ましい。なお、非干渉光を光源に用いる場合、干渉縞防止の粗面化は、特に必要ないが、導電性基体の表面の凹凸による欠陥の発生を抑制するため、より長寿命化に適する。

【0102】

30

粗面化の方法としては、例えば、研磨剤を水に懸濁させて導電性基体に吹き付けることによって行う湿式ホーニング、回転する砥石に導電性基体を圧接し、連続的に研削加工を行うセンタレス研削、陽極酸化処理等が挙げられる。

【0103】

粗面化の方法としては、導電性基体の表面を粗面化することなく、導電性又は半導電性粉体を樹脂中に分散させて、導電性基体の表面上に層を形成し、その層中に分散させる粒子により粗面化する方法も挙げられる。粗面化のための層としては、後述の下引層を用いることも可能である。

【0104】

40

陽極酸化による粗面化処理は、金属製 (例えばアルミニウム製) の導電性基体を陽極とし電解質溶液中で陽極酸化することにより導電性基体の表面に酸化膜を形成するものである。電解質溶液としては、例えば、硫酸溶液、シュウ酸溶液等が挙げられる。しかし、陽極酸化により形成された多孔質陽極酸化膜は、そのままの状態では化学的に活性であり、汚染され易く、環境による抵抗変動も大きい。そこで、多孔質陽極酸化膜に対して、酸化膜の微細孔を加圧水蒸気又は沸騰水中 (ニッケル等の金属塩を加えてもよい) で水和反応による体積膨張でふさぎ、より安定な水和酸化物に変える封孔処理を行うことが好ましい。

【0105】

陽極酸化膜の膜厚は、例えば、 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下が好ましい。この膜厚が上記範囲内にあると、注入に対するバリア性が発揮される傾向があり、また繰り返し使用に

50

よる残留電位の上昇が抑えられる傾向にある。

【0106】

導電性基体には、酸性処理液による処理又はペーマイト処理を施してもよい。

酸性処理液による処理は、例えば、以下のようにして実施される。先ず、リン酸、クロム酸及びフッ酸を含む酸性処理液を調製する。酸性処理液におけるリン酸、クロム酸及びフッ酸の配合割合は、例えば、リン酸が10質量%以上11質量%以下の範囲、クロム酸が3質量%以上5質量%以下の範囲、フッ酸が0.5質量%以上2質量%以下の範囲であって、これらの酸全体の濃度は13.5質量%以上18質量%以下の範囲がよい。処理温度は例えば42℃以上48℃以下が好ましい。被膜の膜厚は、0.3μm以上15μm以下が好ましい。

10

【0107】

ペーマイト処理は、例えば90℃以上100℃以下の純水中に5分から60分間浸漬すること、又は90℃以上120℃以下の加熱水蒸気に5分から60分間接触させて行う。被膜の膜厚は、0.1μm以上5μm以下が好ましい。これをさらにアジピン酸、硼酸、硼酸塩、燐酸塩、フタル酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩等の被膜溶解性の低い電解質溶液を用いて陽極酸化処理してもよい。

【0108】

(下引層)

下引層は、例えば、無機粒子と結着樹脂とを含む層である。

【0109】

無機粒子としては、例えば、粉体抵抗(体積抵抗率) 10^{-2} cm以上 10^{-1} cm以下の無機粒子が挙げられる。

20

これらの中でも、上記抵抗値を有する無機粒子としては、例えば、酸化錫粒子、酸化チタン粒子、酸化亜鉛粒子、酸化ジルコニウム粒子等の金属酸化物粒子がよく、特に、酸化亜鉛粒子が好ましい。

【0110】

無機粒子のBET法による比表面積は、例えば、 $10\text{ m}^2/\text{g}$ 以上がよい。

無機粒子の体積平均粒径は、例えば、50nm以上2000nm以下(好ましくは60nm以上1000nm以下)がよい。

【0111】

無機粒子の含有量は、例えば、結着樹脂に対して、10質量%以上80質量%以下であることが好ましく、より好ましくは40質量%以上80質量%以下である。

30

【0112】

無機粒子は、表面処理が施されていてもよい。無機粒子は、表面処理の異なるもの、又は、粒子径の異なるものを2種以上混合して用いてもよい。

【0113】

表面処理剤としては、例えば、シランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミニウム系カップリング剤、界面活性剤等が挙げられる。特に、シランカップリング剤が好ましく、アミノ基を有するシランカップリング剤がより好ましい。

【0114】

アミノ基を有するシランカップリング剤としては、例えば、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

40

【0115】

シランカップリング剤は、2種以上混合して使用してもよい。例えば、アミノ基を有するシランカップリング剤と他のシランカップリング剤とを併用してもよい。その他のシランカップリング剤としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、3-メタクリルオキシプロピル-トリス(2-メトキシエトキシ)シラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキ

50

シル)エチルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0116】

表面処理剤による表面処理方法は、公知の方法であればいかなる方法でもよく、乾式法又は湿式法のいずれでもよい。

【0117】

表面処理剤の処理量は、例えば、無機粒子に対して0.5質量%以上10質量%以下が好ましい。

【0118】

ここで、下引層は、無機粒子と共に電子受容性化合物(アクセプター化合物)を含有することが、電気特性の長期安定性、キャリアブロック性が高まる観点からよい。

【0119】

電子受容性化合物としては、例えば、クロラニル、プロモアニル等のキノン系化合物；テトラシアノキノジメタン系化合物；2,4,7-トリニトロフルオレノン、2,4,5,7-テトラニトロ-9-フルオレノン等のフルオレノン化合物；2-(4-ビフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、2,5-ビス(4-ナフチル)-1,3,4-オキサジアゾール、2,5-ビス(4-ジエチルアミノフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール等のオキサジアゾール系化合物；キサントン系化合物；チオフエン化合物；3,3',5,5'-テトラ-t-ブチルジフェノキノン等のジフェノキノン化合物；等の電子輸送性物質等が挙げられる。

特に、電子受容性化合物としては、アントラキノン構造を有する化合物が好ましい。アントラキノン構造を有する化合物としては、例えば、ヒドロキシアントラキノン化合物、アミノアントラキノン化合物、アミノヒドロキシアントラキノン化合物等が好ましく、具体的には、例えば、アントラキノン、アリザリン、キニザリン、アントラルフィン、ブルプリン等が好ましい。

【0120】

電子受容性化合物は、下引層中に無機粒子と共に分散して含まれていてもよいし、無機粒子の表面に付着した状態で含まれていてもよい。

【0121】

電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着させる方法としては、例えば、乾式法、又は、湿式法が挙げられる。

【0122】

乾式法は、例えば、無機粒子をせん断力の大きなミキサ等で攪拌しながら、直接又は有機溶媒に溶解させた電子受容性化合物を滴下、乾燥空気や窒素ガスとともに噴霧させて、電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着する方法である。電子受容性化合物の滴下又は噴霧するときは、溶剤の沸点以下の温度で行うことがよい。電子受容性化合物を滴下又は噴霧した後、更に100℃以上で焼き付けを行ってもよい。焼き付けは電子写真特性が得られる温度、時間であれば特に制限されない。

【0123】

湿式法は、例えば、攪拌、超音波、サンドミル、アトライター、ボールミル等により、無機粒子を溶剤中に分散しつつ、電子受容性化合物を添加し、攪拌又は分散した後、溶剤除去して、電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着する方法である。溶剤除去方法は、例えば、ろ過又は蒸留により留去される。溶剤除去後には、更に100℃以上で焼き付けを行ってもよい。焼き付けは電子写真特性が得られる温度、時間であれば特に限定されない。湿式法においては、電子受容性化合物を添加する前に無機粒子の含有水分を除去してもよく、その例として溶剤中で攪拌加熱しながら除去する方法、溶剤と共に沸かせて除去す

10

20

30

40

50

る方法が挙げられる。

【0124】

なお、電子受容性化合物の付着は、表面処理剤による表面処理を無機粒子に施す前又は後に行ってもよく、電子受容性化合物の付着と表面処理剤による表面処理と同時に行ってもよい。

【0125】

電子受容性化合物の含有量は、例えば、無機粒子に対して0.01質量%以上20質量%以下がよく、好ましくは0.01質量%以上10質量%以下である。

【0126】

下引層に用いる結着樹脂としては、例えば、アセタール樹脂（例えばポリビニルブチラール等）、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、カゼイン樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース樹脂、ゼラチン、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン-アルキッド樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、エポキシ樹脂等の公知の高分子化合物；ジルコニウムキレート化合物；チタニウムキレート化合物；アルミニウムキレート化合物；チタニウムアルコキシド化合物；有機チタニウム化合物；シランカップリング剤等の公知の材料が挙げられる。

10

下引層に用いる結着樹脂としては、例えば、電荷輸送性基を有する電荷輸送性樹脂、導電性樹脂（例えばポリアニリン等）等も挙げられる。

20

【0127】

これらの中でも、下引層に用いる結着樹脂としては、上層の塗布溶剤に不溶な樹脂が好適であり、特に、尿素樹脂、フェノール樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂；ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂及びポリビニルアセタール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の樹脂と硬化剤との反応により得られる樹脂が好適である。

これら結着樹脂を2種以上組み合わせて使用する場合には、その混合割合は、必要に応じて設定される。

30

【0128】

下引層には、電気特性向上、環境安定性向上、画質向上のために種々の添加剤を含んでもよい。

添加剤としては、多環縮合系、アゾ系等の電子輸送性顔料、ジルコニウムキレート化合物、チタニウムキレート化合物、アルミニウムキレート化合物、チタニウムアルコキシド化合物、有機チタニウム化合物、シランカップリング剤等の公知の材料が挙げられる。シランカップリング剤は前述のように無機粒子の表面処理に用いられるが、添加剤として更に下引層に添加してもよい。

【0129】

添加剤としてのシランカップリング剤としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、3-メタクリルオキシプロピル-トリス（2-メトキシエトキシ）シラン、2-（3,4-エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-（アミノエチル）-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。

40

【0130】

ジルコニウムキレート化合物としては、例えば、ジルコニウムブトキシド、ジルコニウムアセト酢酸エチル、ジルコニウムトリエタノールアミン、アセチルアセトネートジルコ

50

ニウムブトキシド、アセト酢酸エチルジルコニウムブトキシド、ジルコニウムアセテート、ジルコニウムオキサレート、ジルコニウムラクテート、ジルコニウムホスホネート、オクタン酸ジルコニウム、ナフテン酸ジルコニウム、ラウリン酸ジルコニウム、ステアリン酸ジルコニウム、イソステアリン酸ジルコニウム、メタクリレートジルコニウムブトキシド、ステアレートジルコニウムブトキシド、イソステアレートジルコニウムブトキシド等が挙げられる。

【0131】

チタニウムキレート化合物としては、例えば、テトライソプロピルチタネート、テトラノルマルブチルチタネート、ブチルチタネートダイマー、テトラ(2-エチルヘキシル)チタネート、チタンアセチルアセトネート、ポリチタンアセチルアセトネート、チタンオクチレングリコレート、チタンラクテートアンモニウム塩、チタンラクテート、チタンラクテートエチルエステル、チタントリエタノールアミネート、ポリヒドロキシチタンステアレート等が挙げられる。

10

【0132】

アルミニウムキレート化合物としては、例えば、アルミニウムイソプロピレート、モノブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムブチレート、ジエチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムトリス(エチルアセトアセテート)等が挙げられる。

【0133】

これらの添加剤は、単独で、又は複数の化合物の混合物若しくは重縮合物として用いてもよい。

20

【0134】

下引層は、ビッカース硬度が35以上であることがよい。

下引層の表面粗さ(十点平均粗さ)は、モアレ像抑制のために、使用される露光用レーザー波長の $1/4n$ (n は上層の屈折率)から $1/2$ までに調整されていることがよい。

表面粗さ調整のために下引層中に樹脂粒子等を添加してもよい。樹脂粒子としてはシリコーン樹脂粒子、架橋型ポリメタクリル酸メチル樹脂粒子等が挙げられる。また、表面粗さ調整のために下引層の表面を研磨してもよい。研磨方法としては、バフ研磨、サンドブラスト処理、湿式ホーニング、研削処理等が挙げられる。

30

【0135】

下引層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた下引層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱することで行う。

【0136】

下引層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、公知の有機溶剤、例えば、アルコール系溶剤、芳香族炭化水素溶剤、ハロゲン化炭化水素溶剤、ケトン系溶剤、ケトンアルコール系溶剤、エーテル系溶剤、エステル系溶剤等が挙げられる。

これらの溶剤として具体的には、例えば、メタノール、エタノール、 n -プロパノール、 i so-プロパノール、 n -ブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 n -ブチル、ジオキサノン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム、クロロベンゼン、トルエン等の通常の有機溶剤が挙げられる。

40

【0137】

下引層形成用塗布液を調製するときの無機粒子の分散方法としては、例えば、ロールミル、ボールミル、振動ボールミル、アトライター、サンドミル、コロイドミル、ペイントシェーカー等の公知の方法が挙げられる。

【0138】

下引層形成用塗布液を導電性基体上に塗布する方法としては、例えば、ブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布

50

法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0139】

下引層の膜厚は、例えば、好ましくは15 μm以上、より好ましくは18 μm以上50 μm以下の範囲内に設定される。

【0140】

(中間層)

図示は省略するが、下引層と感光層との間に中間層をさらに設けてもよい。

中間層は、例えば、樹脂を含む層である。中間層に用いる樹脂としては、例えば、アセタール樹脂(例えばポリビニルブチラール等)、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、カゼイン樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース樹脂、ゼラチン、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン-アルキッド樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂等の高分子化合物が挙げられる。

中間層は、有機金属化合物を含む層であってもよい。中間層に用いる有機金属化合物としては、ジルコニウム、チタニウム、アルミニウム、マンガン、ケイ素等の金属原子を含有する有機金属化合物等が挙げられる。

これらの中間層に用いる化合物は、単独で又は複数の化合物の混合物若しくは重縮合物として用いてもよい。

【0141】

これらの中でも、中間層は、ジルコニウム原子又はケイ素原子を含有する有機金属化合物を含む層であることが好ましい。

【0142】

中間層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた中間層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥、必要に応じて加熱することで行う。

中間層を形成する塗布方法としては、浸漬塗布法、突き上げ塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、ブレード塗布法、ナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が用いられる。

【0143】

中間層の膜厚は、例えば、好ましくは0.1 μm以上3 μm以下の範囲に設定される。なお、中間層を下引層として使用してもよい。

【0144】

(電荷発生層)

電荷発生層は、例えば、電荷発生材料と結着樹脂とを含む層である。また、電荷発生層は、電荷発生材料の蒸着層であってもよい。電荷発生材料の蒸着層は、LED(Light Emitting Diode)、有機EL(Electro-Luminescence)イメージアレー等の非干渉性光源を用いる場合に好適である。

【0145】

電荷発生材料としては、ビスアゾ、トリスアゾ等のアゾ顔料；ジプロモアントアントロン等の縮環芳香族顔料；ペリレン顔料；ピロロピロール顔料；フタロシアニン顔料；酸化亜鉛；三方晶系セレン等が挙げられる。

【0146】

これらの中でも、近赤外域のレーザ露光に対応させるためには、電荷発生材料としては、金属フタロシアニン顔料、又は無金属フタロシアニン顔料を用いることが好ましい。具体的には、例えば、特開平5-263007号公報、特開平5-279591号公報等の開示されたヒドロキシガリウムフタロシアニン；特開平5-98181号公報等の開示されたクロロガリウムフタロシアニン；特開平5-140472号公報、特開平5-140473号公報等の開示されたジクロロスズフタロシアニン；特開平4-189873号公報等の開示されたチタニルフタロシアニンがより好ましい。

【0147】

一方、近紫外域のレーザ露光に対応させるためには、電荷発生材料としては、ジプロモアントアントロン等の縮環芳香族顔料；チオインジゴ系顔料；ポルフィラジン化合物；酸化亜鉛；三方晶系セレン；特開2004-78147号公報、特開2005-181992号公報に開示されたビスアゾ顔料等が好ましい。

【0148】

450nm以上780nm以下に発光の中心波長があるLED，有機ELイメージアレ等の非干渉性光源を用いる場合にも、上記電荷発生材料を用いてもよいが、解像度の観点より、感光層を20μm以下の薄膜で用いるときには、感光層中の電界強度が高くなり、基体からの電荷注入による帯電低下、いわゆる黒点と呼ばれる画像欠陥を生じやすくなる。これは、三方晶系セレン、フタロシアニン顔料等のp-型半導体で暗電流を生じやすい電荷発生材料を用いたときに顕著となる。

10

【0149】

これに対し、電荷発生材料として、縮環芳香族顔料、ペリレン顔料、アゾ顔料等のn-型半導体を用いた場合、暗電流を生じ難く、薄膜にしても黒点と呼ばれる画像欠陥を抑制し得る。n-型の電荷発生材料としては、例えば、特開2012-155282号公報の段落[0288]～[0291]に記載された化合物(CG-1)～(CG-27)が挙げられるがこれに限られるものではない。

なお、n-型の判定は、通常使用されるタイムオブフライト法を用い、流れる光電流の極性によって判定され、正孔よりも電子をキャリアとして流しやすいものをn-型とする。

20

【0150】

これらの中でも、電荷発生材料としては、電荷発生効率の点で、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料であることが好ましく、V型のヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料がより好ましい。

特に、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料としては、例えば、600nm以上900nm以下の波長域での分光吸収スペクトルにおいて、810nm以上839nm以下の範囲に最大ピーク波長を有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料がより優れた分散性が得られる観点から好ましい。

【0151】

また、上記の810nm以上839nm以下の範囲に最大ピーク波長を有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、平均粒径が特定の範囲であり、且つ、BET比表面積が特定の範囲であることが好ましい。具体的には、平均粒径が0.20μm以下であることが好ましく、0.01μm以上0.15μm以下であることがより好ましい。一方、BET比表面積が45m²/g以上であることが好ましく、50m²/g以上であることがより好ましく、55m²/g以上120m²/g以下であることが特に好ましい。平均粒径は、体積平均粒径(d₅₀平均粒径)でレーザ回折散乱式粒度分布測定装置(LA-700、堀場製作所社製)にて測定した値である。また、BET式比表面積測定器(島津製作所製：フローソーブII2300)を用い窒素置換法にて測定した値である。

30

【0152】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の最大粒径(一次粒子径の最大値)は、1.2μm以下であることが好ましく、1.0μm以下であることがより好ましく、更に好ましくは0.3μm以下である。

40

【0153】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、平均粒径が0.2μm以下、最大粒径が1.2μm以下であり、且つ、比表面積値が45m²/g以上であることが好ましい。

【0154】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、CuK特性X線を用いたX線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角度(2θ±0.2°)が少なくとも7.3°，16.0°，24.9°，28.0°に回折ピークを有するV型であることが好ましい。

50

【0155】

電荷発生材料は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0156】

電荷発生層に用いる結着樹脂としては、広範な絶縁性樹脂から選択され、また、結着樹脂としては、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリビニルアントラセン、ポリビニルピレン、ポリシラン等の有機光導電性ポリマーから選択してもよい。

結着樹脂としては、例えば、ポリビニルブチラル樹脂、ポリアリレート樹脂（ビスフェノール類と芳香族2価カルボン酸の重縮合体等）、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノキシ樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、ポリビニルピリジン樹脂、セルロース樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、カゼイン、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂等が挙げられる。ここで、「絶縁性」とは、体積抵抗率が 10^{13} cm以上であることをいう。

これらの結着樹脂は1種を単独で又は2種以上を混合して用いられる。

【0157】

なお、電荷発生材料と結着樹脂の配合比は、質量比で10:1から1:10までの範囲内であることが好ましい。

【0158】

電荷発生層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0159】

電荷発生層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた電荷発生層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱することで行う。なお、電荷発生層の形成は、電荷発生材料の蒸着により行ってもよい。電荷発生層の蒸着による形成は、特に、電荷発生材料として縮環芳香族顔料、ペリレン顔料を利用する場合に好適である。

【0160】

電荷発生層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、メタノール、エタノール、n-プロパノール、n-ブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸n-ブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム、クロロベンゼン、トルエン等が挙げられる。これら溶剤は、1種を単独で又は2種以上を混合して用いる。

【0161】

電荷発生層形成用塗布液中に粒子（例えば電荷発生材料）を分散させる方法としては、例えば、ボールミル、振動ボールミル、アトライター、サンドミル、横型サンドミル等のメディア分散機や、攪拌、超音波分散機、ロールミル、高圧ホモジナイザー等のメディアレス分散機が利用される。高圧ホモジナイザーとしては、例えば、高圧状態で分散液を液-液衝突や液-壁衝突させて分散する衝突方式や、高圧状態で微細な流路を貫通させて分散する貫通方式等が挙げられる。

なお、この分散の際、電荷発生層形成用塗布液中の電荷発生材料の平均粒径を $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以下、更に好ましくは $0.15\text{ }\mu\text{m}$ 以下にすることが有効である。

【0162】

電荷発生層形成用塗布液を下引層上（又は中間層上）に塗布する方法としては、例えばブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0163】

電荷発生層の膜厚は、例えば、好ましくは $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $5.0\text{ }\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 以下の範囲内に設定される。

【0164】

(電荷輸送層)

電荷輸送層は、例えば、電荷輸送材料と結着樹脂とを含む層である。

電荷輸送材料としては、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)及びベンジジン系電荷輸送材料(CT2)が適用される。そして、ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)及びベンジジン系電荷輸送材料(CT2)を含む電荷輸送層には、更に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種を含む。更に、電荷輸送層には、フッ素含有樹脂粒子、およびフッ素含有分散剤を含んでもよい。

【0165】

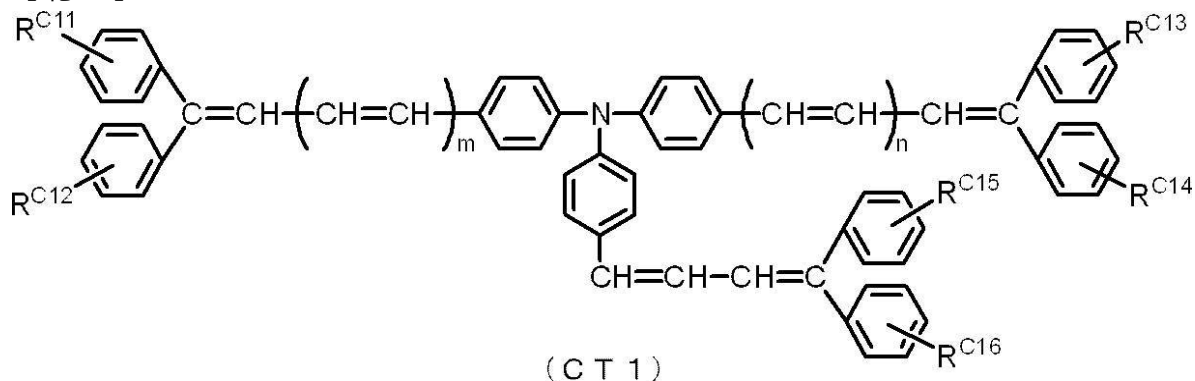
- 電荷輸送材料 -

ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)について説明する。

ブタジエン系電荷輸送材料(CT1)は、下記一般式(CT1)で示される電荷輸送材料である。

【0166】

【化8】



【0167】

一般式(CT1)中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上20以下のアルキル基、炭素数1以上20以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上30以下のアリール基を表し、隣接する2つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。

n 及び m は、各々独立に、0、1又は2を表す。

【0168】

一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

【0169】

一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアルキル基としては、炭素数1以上20以下(好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下)の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、 n -ブチル基、 n -ペンチル基、 n -ヘキシル基、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、 n -ノニル基、 n -デシル基、 n -ウンデシル基、 n -ドデシル基、 n -トリデシル基、 n -テトラデシル基、 n -ペンタデシル基、 n -ヘキサデシル基、 n -ヘプタデシル基、 n -オクタデシル基、 n -ノナデシル基、 n -イコシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 $tert$ -ペンチル基、イソヘキシル基、 sec -ヘキシル基、 $tert$ -ヘキシル基、イソヘプチル基、 sec -ヘプチル基、 $tert$ -ヘプチル基、イソオクチル基、 sec -オクチル基、 $tert$ -オクチル基、イソノニル基、 sec -ノニル基、 $tert$ -ノニル基、イソデシル基、

sec - デシル基、tert - デシル基、イソウンデシル基、sec - ウンデシル基、tert - ウンデシル基、ネオウンデシル基、イソドデシル基、sec - ドデシル基、tert - ドデシル基、ネオドデシル基、イソトリデシル基、sec - トリデシル基、tert - トリデシル基、ネオトリデシル基、イソテトラデシル基、sec - テトラデシル基、tert - テトラデシル基、ネオテトラデシル基、1 - イソブチル - 4 - エチルオクチル基、イソペンタデシル基、sec - ペンタデシル基、tert - ペンタデシル基、ネオペンタデシル基、イソヘキサデシル基、sec - ヘキサデシル基、tert - ヘキサデシル基、ネオヘキサデシル基、1 - メチルペンタデシル基、イソヘプタデシル基、sec - ヘプタデシル基、tert - ヘプタデシル基、ネオヘプタデシル基、イソオクタデシル基、sec - オクタデシル基、tert - オクタデシル基、ネオオクタデシル基、イソノナデシル基、sec - ノナデシル基、tert - ノナデシル基、ネオノナデシル基、1 - メチルオクチル基、イソイコシル基、sec - イコシル基、tert - イコシル基、ネオイコシル基等が挙げられる。

10

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0170】

一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアルコキシ基としては、炭素数 1 以上 20 以下 (好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下) の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、n - プロポキシ基、n - ブトキシ基、n - ペンチルオキシ基、n - ヘキシルオキシ基、n - ヘプチルオキシ基、n - オクチルオキシ基、n - ノニルオキシ基、n - デシルオキシ基、n - ウンデシルオキシ基、n - ドデシルオキシ基、n - トリデシルオキシ基、n - テトラデシルオキシ基、n - ペンタデシルオキシ基、n - ヘキサデシルオキシ基、n - ヘプタデシルオキシ基、n - オクタデシルオキシ基、n - ノナデシルオキシ基、n - イコシルオキシ基等が挙げられる。

20

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、sec - ブトキシ基、tert - ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、tert - ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、sec - ヘキシルオキシ基、tert - ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、sec - ヘプチルオキシ基、tert - ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、sec - オクチルオキシ基、tert - オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、sec - ノニルオキシ基、tert - ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、sec - デシルオキシ基、tert - デシルオキシ基、イソウンデシルオキシ基、sec - ウンデシルオキシ基、tert - ウンデシルオキシ基、ネオウンデシルオキシ基、イソドデシルオキシ基、sec - ドデシルオキシ基、tert - ドデシルオキシ基、ネオドデシルオキシ基、イソトリデシルオキシ基、sec - トリデシルオキシ基、tert - トリデシルオキシ基、ネオトリデシルオキシ基、イソテトラデシルオキシ基、sec - テトラデシルオキシ基、tert - テトラデシルオキシ基、ネオテトラデシルオキシ基、1 - イソブチル - 4 - エチルオクチルオキシ基、イソペンタデシルオキシ基、sec - ペンタデシルオキシ基、tert - ペンタデシルオキシ基、ネオペンタデシルオキシ基、イソヘキサデシルオキシ基、sec - ヘキサデシルオキシ基、tert - ヘキサデシルオキシ基、ネオヘキサデシルオキシ基、1 - メチルペンタデシルオキシ基、イソヘプタデシルオキシ基、sec - ヘプタデシルオキシ基、tert - ヘプタデシルオキシ基、ネオヘプタデシルオキシ基、イソオクタデシルオキシ基、sec - オクタデシルオキシ基、tert - オクタデシルオキシ基、ネオオクタデシルオキシ基、イソノナデシルオキシ基、sec - ノナデシルオキシ基、tert - ノナデシルオキシ基、ネオノナデシルオキシ基、1 - メチルオクチルオキシ基、イソイコシルオキシ基、sec - イコシルオキシ基、tert - イコシルオキシ基、ネオイコシルオキシ基等が挙げられる。

30

40

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0171】

50

一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアリール基としては、炭素数 6 以上 30 以下（好ましくは 6 以上 20 以下、より好ましくは 6 以上 16 以下）のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、ピフェニル基などが挙げられる。

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基が好ましい。

【0172】

なお、一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基（例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など）が挙げられる。

10

【0173】

一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} の隣接する二つの置換基同士（例えば R^{C11} 及び R^{C12} 同士、 R^{C13} 及び R^{C14} 同士、 R^{C15} 及び R^{C16} 同士）が連結した炭化水素環構造における、当該置換基同士を連結する基としては、単結合、2, 2'-メチレン基、2, 2'-エチレン基、2, 2'-ビニレン基などが挙げられ、これらの中でも単結合、2, 2'-メチレン基が好ましい。

ここで、炭化水素環構造として具体的には、例えば、シクロアルカン構造、シクロアルケン構造、シクロアルカンポリエン構造等が挙げられる。

20

【0174】

一般式 (CT1) において、 n 及び m は、1 であることが好ましい。

【0175】

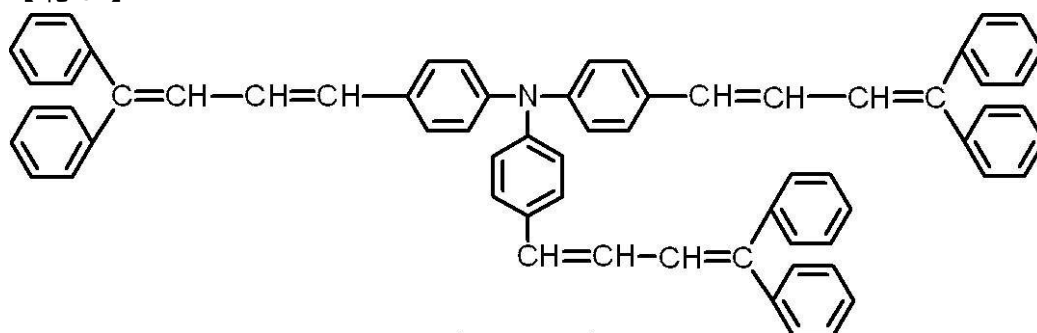
一般式 (CT1) において、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、又は炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基を表し、 m 及び n が 1 又は 2 を表することが好ましく、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、 m 及び n が 1 を表すことがより好ましい。

つまり、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) は、下記構造式 (CT1A) で示される電荷輸送材料（例示化合物 (CT1-3)）であることがより好ましい。

30

【0176】

【化9】



(CT1A)

40

【0177】

以下に、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0178】

【化 1 0】

例示化合物 No.	m	n	R ^{C11}	R ^{C12}	R ^{C13}	R ^{C14}	R ^{C15}	R ^{C16}
CT1- 1	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1- 2	2	2	H	H	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 3	1	1	H	H	H	H	H	H
CT1- 4	2	2	H	H	H	H	H	H
CT1- 5	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	H
CT1- 6	0	1	H	H	H	H	H	H
CT1- 7	0	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 8	0	1	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 9	0	1	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1-10	0	1	H	H	3-CH ₃	3-CH ₃	H	H
CT1-11	0	1	4-CH ₃	H	H	H	4-CH ₃	H
CT1-12	0	1	4-OCH ₃	H	H	H	4-OCH ₃	H
CT1-13	0	1	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃	H	H
CT1-14	0	1	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
CT1-15	0	1	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H
CT1-16	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1-17	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1-18	1	1	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1-19	1	1	H	H	3-CH ₃	3-CH ₃	H	H
CT1-20	1	1	4-CH ₃	H	H	H	4-CH ₃	H
CT1-21	1	1	4-OCH ₃	H	H	H	4-OCH ₃	H
CT1-22	1	1	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃	H	H
CT1-23	1	1	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
CT1-24	1	1	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H

10

20

30

【 0 1 7 9】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

- ・ - CH₃ : メチル基
- ・ - OCH₃ : メトキシ基

【 0 1 8 0】

ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

40

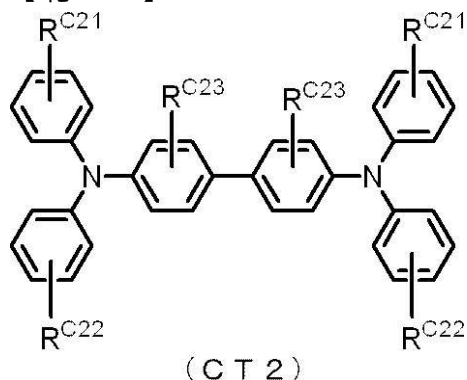
【 0 1 8 1】

ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) について説明する。

ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) は、下記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料である。

【 0 1 8 2】

【化 1 1】



10

【0183】

一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。

【0184】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

20

【0185】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアルキル基としては、炭素数 1 以上 10 以下（好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

30

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0186】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアルコキシ基としては、炭素数 1 以上 10 以下（好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基等が挙げられる。

40

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、*tert*-ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、*sec*-ヘキシルオキシ基、*tert*-ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、*sec*-ヘプチルオキシ基、*tert*-ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、*sec*-オクチルオキシ基、*tert*-オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、*sec*-ノニルオキシ基、*tert*-ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、*sec*-デシルオキシ基、*tert*-デシルオキシ基等が挙げられる。

50

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0187】

一般式(CT2)において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアリール基としては、炭素数6以上10以下(好ましくは6以上9以下、より好ましくは6以上8以下)のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基が好ましい。

【0188】

なお、一般式(CT2)において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基(例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など)が挙げられる。

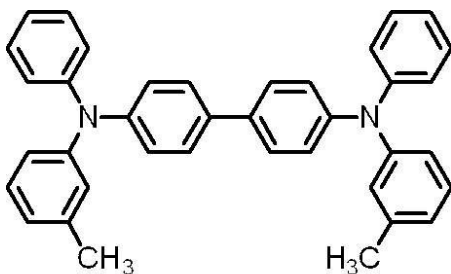
【0189】

一般式(CT2)において、特に、電荷輸送能の高い感光層(電荷輸送層)形成の点から、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が、各々独立に、水素原子、又は、炭素数1以上10以下のアルキル基を表すことが好ましく、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数1以上10以下のアルキル基(特に、メチル基)を表すことがより好ましい。

具体的には、ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)は、下記構造式(CT2A)で示される電荷輸送材料(例示化合物(CT2-2))であることが特に好ましい。

【0190】

【化12】



(CT2A)

【0191】

以下に、ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0192】

10

20

30

【化 1 3】

例示化合物 No.	R ^{C21}	R ^{C22}	R ^{C23}
CT2- 1	H	H	H
CT2- 2	H	3-CH ₃	H
CT2- 3	H	4-CH ₃	H
CT2- 4	H	3-C ₂ H ₅	H
CT2- 5	H	4-C ₂ H ₅	H
CT2- 6	H	3-OCH ₃	H
CT2- 7	H	4-OCH ₃	H
CT2- 8	H	3-OC ₂ H ₅	H
CT2- 9	H	4-OC ₂ H ₅	H
CT2-10	3-CH ₃	3-CH ₃	H
CT2-11	4-CH ₃	4-CH ₃	H
CT2-12	3-C ₂ H ₅	3-C ₂ H ₅	H
CT2-13	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅	H
CT2-14	H	H	2-CH ₃
CT2-15	H	H	3-CH ₃
CT2-16	H	3-CH ₃	2-CH ₃
CT2-17	H	3-CH ₃	3-CH ₃
CT2-18	H	4-CH ₃	2-CH ₃
CT2-19	H	4-CH ₃	3-CH ₃
CT2-20	3-CH ₃	3-CH ₃	2-CH ₃
CT2-21	3-CH ₃	3-CH ₃	3-CH ₃
CT2-22	4-CH ₃	4-CH ₃	2-CH ₃
CT2-23	4-CH ₃	4-CH ₃	3-CH ₃

10

20

30

【0 1 9 3】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

- ・ - C H ₃ : メチル基
- ・ - C ₂ H ₅ : エチル基
- ・ - O C H ₃ : メトキシ基
- ・ - O C ₂ H ₅ : エトキシ基

40

【0 1 9 4】

ベンジジン系電荷輸送材料 (C T 2) は、1 種を単独で用いてもよいし、2 種以上を併用してもよい。

【0 1 9 5】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤について説明する。

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、ヒンダードフェノール環を有し、且つ分子量が 3 0 0 以上の化合物である。

50

【 0 1 9 6 】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、ヒンダードフェノール環は、例えば、炭素数 4 以上 8 以下のアルキル基（例えば炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基）が少なくとも一つ置換されたフェノール環である。より具体的には、ヒンダードフェノール環は、例えば、フェノール性水酸基に対してオルトの位置が三級アルキル基（例えば *tert*-ブチル基）で置換されたフェノール環である。

【 0 1 9 7 】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、

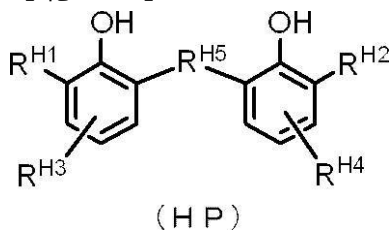
- 1) ヒンダードフェノール環を 1 つ有する酸化防止剤、
 - 2) ヒンダードフェノール環を 2 つ以上 4 つ以下有し、且つ直鎖又は分岐状の 2 価以上 4 価以下の脂肪族炭化水素基からなる連結基、又は 2 価以上 4 価以下の脂肪族炭化水素基の炭素 - 炭素の結合間に、エステル結合 (- C (= O) O -) 及びエーテル結合 (- O -) の少なくとも一方が介在した連結基で、2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環が連結された酸化防止剤
 - 3) 2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環と、一つのベンゼン環（未置換、又はアルキル基等で置換された置換ベンゼン環）又はイソシアヌレート環とを有し、2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環が、各々、ベンゼン環又はイソシアヌレート環とアルキレン基を介して連結された酸化防止剤
- 等が挙げられる。

【 0 1 9 8 】

具体的には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、下記一般式 (H P) で示される酸化防止剤が好ましい。

【 0 1 9 9 】

【 化 1 4 】



【 0 2 0 0 】

一般式 (H P) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基を表す。

R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す。

R^{H5} は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基を表す。

【 0 2 0 1 】

一般式 (H P) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} が表すアルキル基としては、炭素数 4 以上 8 以下（好ましくは炭素数 4 以上 6 以下）の分岐状のアルキル基が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基が挙げられる。

これらの中でも、アルキル基としては、*tert*-ブチル基、*tert*-ペンチル基が好ましく、*tert*-ブチル基がより好ましい。

【 0 2 0 2 】

一般式 (H P) 中、 R^{H3} 、及び R^{H4} としては、炭素数 1 以上 10 以下（好ましくは炭素数 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブ

チル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0203】

一般式(HP)中、 R^{H5} は、炭素数1以上10以下(好ましくは炭素数1以上4以下)の直鎖状又は分岐状アルキレン基を表す。

直鎖状のアルキレン基として具体的には、メチレン基、エチレン基、*n*-プロピレン基、*n*-ブチレン基、*n*-ペンチレン基、*n*-ヘキシレン基、*n*-ヘプチレン基、*n*-オクチレン基、*n*-ノニレン基、*n*-デシレン基等が挙げられる。

分岐状のアルキレン基として具体的には、イソプロピレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、イソペンチレン基、ネオペンチレン基、*tert*-ペンチレン基、イソヘキシレン基、*sec*-ヘキシレン基、*tert*-ヘキシレン基、イソヘプチレン基、*sec*-ヘプチレン基、*tert*-ヘプチレン基、イソオクチレン基、*sec*-オクチレン基、*tert*-オクチレン基、イソノニレン基、*sec*-ノニレン基、*tert*-ノニレン基、イソデシレン基、*sec*-デシレン基、*tert*-デシレン基等が挙げられる。

これらの中でも、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、ブチレン基等の低級アルキレン基が好ましい。

【0204】

なお、一般式(HP)中、 R^{H1} 、 R^{H2} 、 R^{H3} 、 R^{H4} 、及び R^{H5} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、例えば、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子)、アルコキシ基(例えば炭素数1以上4以下のアルコキシ基)、アリール基(例えばフェニル基、ナフチル基等)等が挙げられる。

【0205】

一般式(HP)において、特に、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、 R^{H1} 、及び R^{H2} が*tert*-ブチル基を表すことが好ましく、 R^{H1} 、及び R^{H2} が*tert*-ブチル基を表し、 R^{H3} 、及び R^{H4} が炭素数1以上3以下のアルキル基(特にメチル基)を示し、 R^{H5} が炭素数1以上4以下のアルキレン基(特にメチレン基)を表すことが好ましい。

具体的には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、例示化合物(HP-3)で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤が特に好ましい。

【0206】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、300以上1000以下が好ましく、300以上900以下がより好ましく、300以上800以下が更に好ましい。

【0207】

以下に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0208】

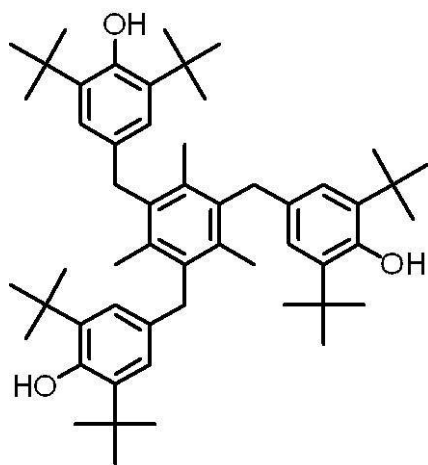
10

20

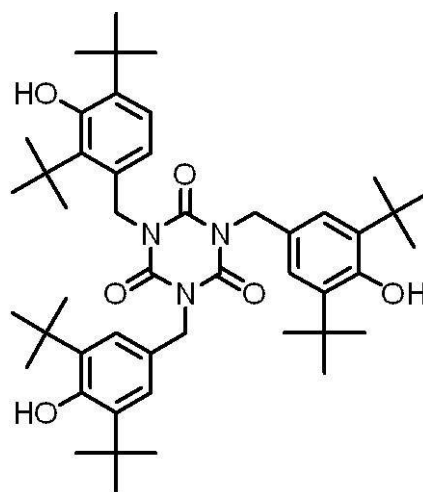
30

40

【化 1 5】

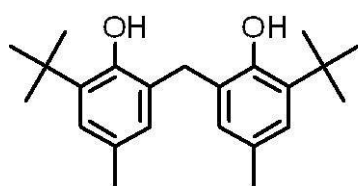


(HP-1)



(HP-2)

10

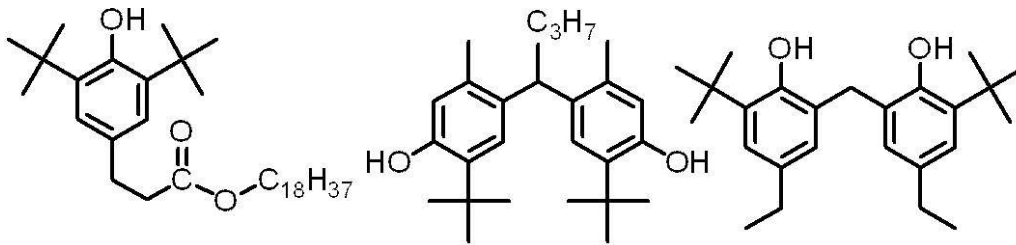


(HP-3)

20

【 0 2 0 9 】

【化 1 6】

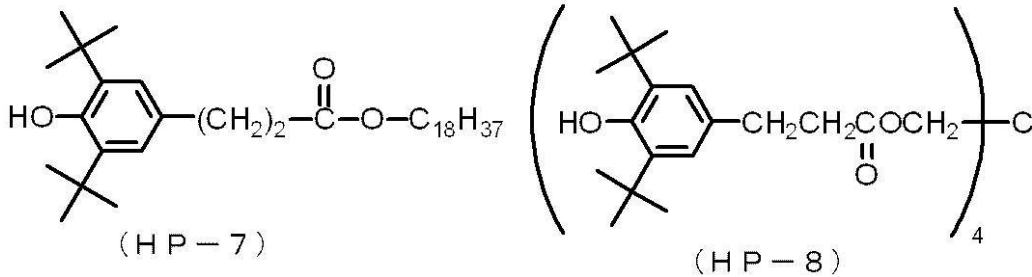


(HP-4)

(HP-5)

(HP-6)

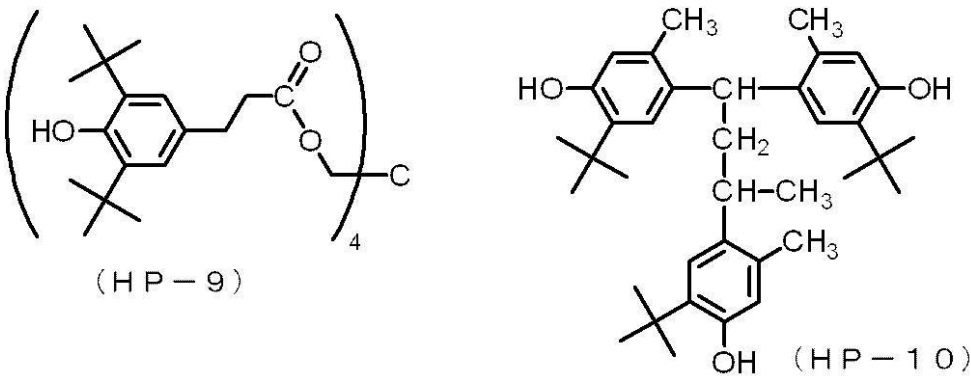
10



(HP-7)

(HP-8)

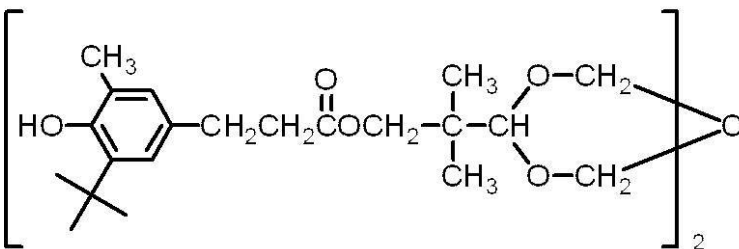
20



(HP-9)

(HP-10)

30



(HP-11)

40

【0210】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0211】

次に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤について説明する。

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、ベンゾフェノン骨格を有する化合物である。

【0212】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、1) 2つのベンゼン環が無置換の化合物、2) 2つのベンゼン環に、各々に独立に、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、及びアリール基よりなる群から選択される少なくとも一つの置換基で置換された化合物が挙げられる。特に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、2つのベンゼン環の一方に、

50

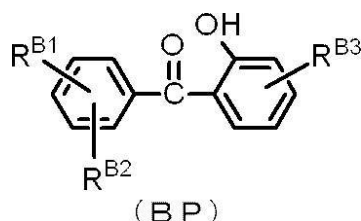
少なくとも水酸基が置換（特に、 $-C(=O)-$ 基に対してオルトの位置に置換）されている化合物がよい。

【0213】

具体的には、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、下記一般式（BP）で示される紫外線吸収剤が好ましい。

【0214】

【化17】



10

【0215】

一般式（BP）中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上10以下のアリアル基を表す。

【0216】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

20

【0217】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアルキル基としては、炭素数1以上10以下（好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

30

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0218】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアルコキシ基としては、炭素数1以上10以下（好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下）の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

40

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基等が挙げられる。

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、*tert*-ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、*sec*-ヘキシルオキシ基、*tert*-ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、*sec*-ヘプチルオキシ基、*tert*-ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、*sec*-オクチルオキシ基、*tert*-オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、*sec*-ノニルオキシ基、*tert*-ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、*sec*-デシルオキシ基、*tert*-デシルオキシ基等が挙げられる。

50

げられる。

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0219】

一般式(BP)において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアリール基としては、炭素数6以上10以下(好ましくは6以上9以下、より好ましくは6以上8以下)のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基が好ましい。

【0220】

なお、一般式(BP)において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基(例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など)が挙げられる。

10

【0221】

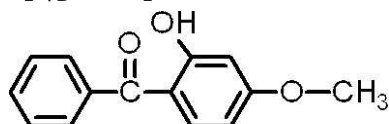
一般式(BP)において、特に、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、 R^{B1} 、及び R^{B2} が水素原子を表し、 R^{B3} が炭素数1以上3以下のアルコキシ基を表すことが好ましい。

具体的には、紫外線吸収剤は、下記構造式(BPA)で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤(例示化合物(BP-3))であることが特に好ましい。

【0222】

【化18】

20



(BPA)

【0223】

以下に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤(一般式(BP)で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤)の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0224】

30

【化 1 9】

例示化合物 No.	R ^{B1}	R ^{B2}	R ^{B3}
BP- 1	H	H	4-OH
BP- 2	H	H	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 3	H	H	4-OCH ₃
BP- 4	H	H	H
BP- 5	H	3-CH ₃	4-OH
BP- 6	H	3-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 7	H	3-CH ₃	4-OCH ₃
BP- 8	H	3-CH ₃	H
BP- 9	H	4-CH ₃	4-OH
BP- 10	H	4-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 11	H	4-CH ₃	4-OCH ₃
BP- 12	H	4-CH ₃	H
BP- 13	2-CH ₃	4-CH ₃	4-OH
BP- 14	2-CH ₃	4-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 15	2-CH ₃	4-CH ₃	4-OCH ₃
BP- 16	2-CH ₃	4-CH ₃	H
BP- 17	H	3-C ₂ H ₅	4-OH
BP- 18	H	3-C ₂ H ₅	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 19	H	3-C ₂ H ₅	4-OCH ₃
BP- 20	H	3-C ₂ H ₅	H
BP- 21	H	4-C ₂ H ₅	4-OH
BP- 22	H	4-C ₂ H ₅	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 23	H	4-C ₂ H ₅	4-OCH ₃
BP- 24	H	4-C ₂ H ₅	H

10

20

30

【0 2 2 5】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

40

- ・ - CH₃ : メチル基
- ・ - C₂H₅ : エチル基
- ・ - (CH₂)₇-CH₃ : オクチル基
- ・ - OCH₃ : メトキシ基
- ・ - OH : ヒドロキシ基

【0 2 2 6】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0 2 2 7】

50

次に、電荷輸送材料、酸化防止剤および紫外線吸収剤の含有量について説明する。

ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）の含有量は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、ＣＴ１と結着樹脂との配合比（質量比　ＣＴ１：結着樹脂）で０．１：９．９から４．０：６．０までの範囲内であることが好ましく、０．４：９．６から３．５：６．５までの範囲内であることがより好ましく、０．６：９．４から３．０：７．０の範囲内であることが更に好ましい。

【０２２８】

ベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）の含有量は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、ＣＴ２と結着樹脂の配合比は、質量比で１：９から７：３までの範囲内であることが好ましく、２：８から６：４までの範囲内であることがより好ましく、２：８から４：６の範囲内であることが更に好ましい。

10

【０２２９】

ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）の含有量とベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）の含有量との質量比（ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）の含有量／ベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）の含有量）は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、１／９以上５／５以下が好ましく、１／９以上４／６以下がより好ましく、１／９以上３／７以下が更に好ましい。

特に、ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）の含有量とベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）の含有量との質量比が上記範囲であると、焼付きゴースト及び光疲労が生じ易いが、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも１種により、焼付きゴースト及び光疲労の発生が抑制される。

20

【０２３０】

なお、ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）およびベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）以外の他の電荷輸送材料を併用してもよい。但し、その場合、全電荷輸送材料に占める他の電荷輸送材料の含有量は、１０質量％以下（好ましくは５質量％以下）であることがよい。

【０２３１】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤の含有量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、全電荷輸送材料量１００質量％に対して、０．５質量％以上３０．０質量％以下が好ましく、０．５質量％以上１５質量％以下がより好ましく、０．５質量％以上９．０質量％以下が更に好ましい。なお、このヒンダードフェノール系酸化防止剤の含有量は、全電荷輸送材料の含有量を１００質量部としたときの部数（質量部）を示している。

30

【０２３２】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、全電荷輸送材料量１００質量％に対して、０．５質量％以上３０．０質量％以下が好ましく、０．５質量％以上１５質量％以下がより好ましく、０．５質量％以上９．０質量％以下が更に好ましい。なお、このベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、全電荷輸送材料の含有量を１００質量部としたときの部数（質量部）を示している。

【０２３３】

なお、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、共に、３０．０質量％以下とすることで、酸化防止剤および紫外線吸収剤による電荷輸送材料の電荷輸送能力の障害が抑制される。つまり、光照射による感光体表面への静電潜像形成の障害が抑制され、目的とする濃度の画像が得られ易くなる。

40

【０２３４】

次に結着樹脂について説明する。

電荷輸送層に用いる結着樹脂は、ＢＰポリカーボネート樹脂が適用される。ＢＰポリカーボネート樹脂は、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂である。

【０２３５】

ＢＰポリカーボネート樹脂としては、例えば、ビフェニル骨格を有する構造単位として

50

、下記一般式（PCA）で示される構造単位と、他の構造単位とを有するビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が挙げられる。

他の構造単位としては、ビスフェノール骨格（例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールB、ビスフェノールBP、ビスフェノールC、ビスフェノールF、ビスフェノールZ等）を有する構造単位等が挙げられる。

【0236】

BPポリカーボネート樹脂として具体的には、例えば、ジヒドロキシビフェニル化合物と、ジヒドロキシビスフェノール化合物との共重合体が挙げられる。なお、この共重合体は、例えば、ジヒドロキシビフェニル化合物およびジヒドロキシビスフェノール化合物を原料として用い、ホスゲン等の炭酸エステル形成性化合物との重縮合又はビスアリールカーボネートとのエステル交換反応等の方法によって得られる。

【0237】

ジヒドロキシビフェニル化合物は、ビフェニル骨格を有し、ビフェニル骨格の2つのベンゼン環に、各々、一つのヒドロキシル基を有するビフェニル化合物である。ジヒドロキシビフェニル化合物としては、例えば、4,4'-ジヒドロキシビフェニル、4,4'-ジヒドロキシ-3,3'-ジメチルビフェニル、4,4'-ジヒドロキシ-2,2'-ジメチルビフェニル、4,4'-ジヒドロキシ-3,3'-ジシクロヘキシルビフェニル、3,3'-ジフルオロ-4,4'-ジヒドロキシビフェニル、4,4'-ジヒドロキシ-3,3'-ジフェニルビフェニル等が挙げられる。

これらジヒドロキシビフェニル化合物は、1種単独で用いてもよいし、複数併用してもよい。

【0238】

ジヒドロキシビスフェノール化合物は、ビスフェノール骨格を有し、ビスフェノール骨格の2つのベンゼン環に、各々、一つのヒドロキシル基を有するビスフェノール化合物である。ジヒドロキシビスフェノール化合物としては、例えば、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)オクタン、4,4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ヘブタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1,1-ジフェニルメタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)エーテル、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルフィド、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スルフィド、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス(2-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ブタン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)エタン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)プロパン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ブタン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)イソブタン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ヘブタン、1,1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-1-フェニルメタン、1,1-ビス(2-tert-アミル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ブタン、ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)メタン、2,2-ビス(3-クロロ-4-ヒド

10

20

30

40

50

ロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-ブromo-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-ブromo-4-ヒドロキシ-5-クロロフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)ブタン、1-フェニル-1,1-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)エタン、ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)エーテル、1,1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン等が挙げられる。

10

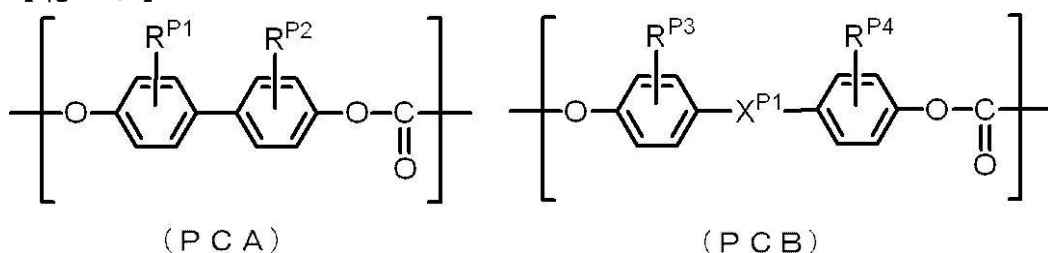
これらビスフェノール化合物は、1種単独で用いてもよいし、複数併用してもよい。

【0239】

これらの中でも、BPポリカーボネート樹脂は、感光層(電荷輸送層)の耐摩耗性の点から、下記一般式(PC A)で示される構造単位と、下記一般式(PC B)で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂であることが好ましい。

【0240】

【化20】



20

【0241】

一般式(PC A)及び(PC B)中、 $\text{R}^{\text{P}1}$ 、 $\text{R}^{\text{P}2}$ 、 $\text{R}^{\text{P}3}$ 、及び $\text{R}^{\text{P}4}$ は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上6以下のアルキル基、炭素数5以上7以下のシクロアルキル基、又は、炭素数6以上12以下のアリール基を表す。 $\text{X}^{\text{P}1}$ は、フェニレン基、ピフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を表す。

30

【0242】

一般式(PC A)及び(PC B)中、 $\text{R}^{\text{P}1}$ 、 $\text{R}^{\text{P}2}$ 、 $\text{R}^{\text{P}3}$ 、及び $\text{R}^{\text{P}4}$ が表すアルキル基としては、炭素数1以上6以下(好ましくは炭素数1以上3以下)の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、イソヘキシル基、sec-ヘキシル基、tert-ヘキシル基等が挙げられる。

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基等の低級アルキル基が好ましい。

40

【0243】

一般式(PC A)及び(PC B)中、 $\text{R}^{\text{P}1}$ 、 $\text{R}^{\text{P}2}$ 、 $\text{R}^{\text{P}3}$ 、及び $\text{R}^{\text{P}4}$ が表すシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルが挙げられる。

【0244】

一般式(PC A)及び(PC B)中、 $\text{R}^{\text{P}1}$ 、 $\text{R}^{\text{P}2}$ 、 $\text{R}^{\text{P}3}$ 、及び $\text{R}^{\text{P}4}$ が表すアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、ピフェニル基等が挙げられる。

【0245】

一般式(PC A)及び(PC B)中、 $\text{X}^{\text{P}1}$ が表すアルキレン基としては、炭素数1以

50

上 1 2 以下（好ましくは炭素数 1 以上 6 以下、より好ましくは炭素数 1 以上 3 以下）の直鎖状又は分岐状のアルキレン基が挙げられる。

直鎖状のアルキレン基として具体的には、メチレン基、エチレン基、*n*-プロピレン基、*n*-ブチレン基、*n*-ペンチレン基、*n*-ヘキシレン基、*n*-ヘプチレン基、*n*-オクチレン基、*n*-ノニレン基、*n*-デシレン基、*n*-ウンデシレン基、*n*-ドデシレン基等が挙げられる。

分岐状のアルキレン基として具体的には、イソプロピレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、イソペンチレン基、ネオペンチレン基、*tert*-ペンチレン基、イソヘキシレン基、*sec*-ヘキシレン基、*tert*-ヘキシレン基、イソヘプチレン基、*sec*-ヘプチレン基、*tert*-ヘプチレン基、イソオクチレン基、*sec*-オクチレン基、*tert*-オクチレン基、イソノニレン基、*sec*-ノニレン基、*tert*-ノニレン基、イソデシレン基、*sec*-デシレン基、*tert*-デシレン基、イソウンデシレン基、*sec*-ウンデシレン基、*tert*-ウンデシレン基、ネオウンデシレン基、イソドデシレン基、*sec*-ドデシレン基、*tert*-ドデシレン基、ネオドデシレン基等が挙げられる。

これらの中でも、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、ブチレン基等の低級アルキル基が好ましい。

【0246】

一般式 (PCA) 及び (PCB) 中、 X^{P1} が表すシクロアルキレン基としては、炭素数 3 以上 12 以下（好ましくは炭素数 3 以上 10 以下、より好ましくは炭素数 5 以上 8 以下）のシクロアルキレン基が挙げられる。

シクロアルキル基として具体的には、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロドデカニル基等が挙げられる。

これらの中でも、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基が好ましい。

【0247】

なお、一般式 (PCA) 及び (PCB) 中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、及び X^{P1} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、例えば、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子）、アルキル基（例えば炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基）、シクロアルキル基（例えば炭素数 5 以上 7 以下のシクロアルキル基）、アルコキシ基（例えば炭素数 1 以上 4 以下のアルコキシ基）、アリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基、ピフェニリル基等）等が挙げられる。

【0248】

一般式 (PCA) において、 R^{P1} 、及び R^{P2} は、各々独立に、水素原子、又は炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基を表すことが好ましく、 R^{P1} 、及び R^{P2} は、水素原子を表すことがより好ましい。

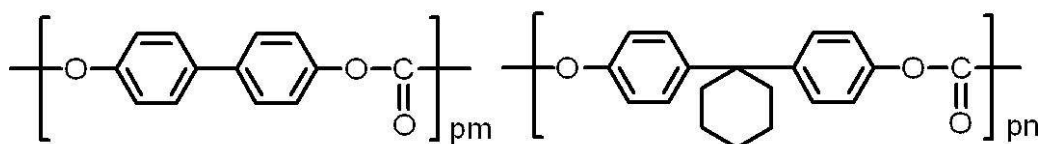
一般式 (PCB) において、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、又は炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基を表し、 X^{P1} がアルキレン基、又はシクロアルキレン基を表すことが好ましい。

【0249】

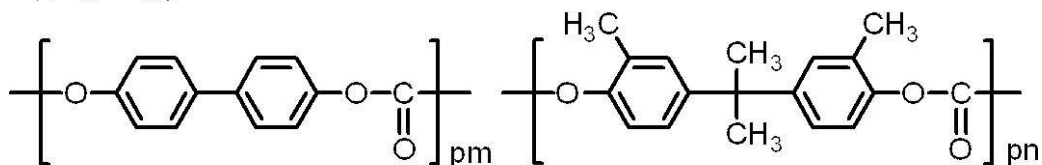
B P ポリカーボネート樹脂の具体例としては、例えば、以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、例示化合物中、*p*m、*p*n は共重合比を示す。

【0250】

【化 2 1】
(PC-1)

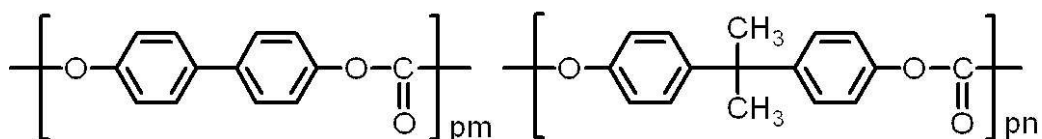


(PC-2)



10

(PC-3)



20

【0 2 5 1】

ここで、BPポリカーボネート樹脂において、一般式(PC-A)で示される構造単位の含有率(共重合比)は、BPポリカーボネート樹脂を構成する全構造単位に対して5モル%以上95モル%以下の範囲がよく、感光層(電荷輸送層)の耐磨耗性を高める観点から、好ましくは5モル%以上50モル%以下の範囲、さらに好ましくは15モル%以上30モル%以下の範囲である。

具体的には、BPポリカーボネート樹脂の上記例示化合物中、pm、pnは共重合比(モル比)を示すが、pm:pn=95:5から5:95の範囲、50:50から5:95の範囲、更に好ましくは、15:85から30:70の範囲が挙げられる。

【0 2 5 2】

BPポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量としては、例えば20,000以上80,000以下が好ましい。

なお、BPポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量の測定方法としては、次の方法により測定される値である。樹脂1gをメチレンクロライド100cm³に均一溶解し、25の測定環境下でウペローデ粘度計により、その比粘度spを測定し、 $sp/c = [] + 0.45 []^2$ の関係式(ただしcは濃度(g/cm³)より極限粘度[](cm³/g)をもとめ、H.Schneilによって与えられている式、[] = $1.23 \times 10^{-4} Mv$ 、0.83の関係式より粘度平均分子量Mvを求める。

【0 2 5 3】

BPポリカーボネート樹脂は、他の結着樹脂と併用してもよい。ただし、他の結着樹脂は、全結着樹脂に対して10質量%(好ましくは5質量%以下)で併用することがよい。

40

【0 2 5 4】

ここで、BPポリカーボネート樹脂の含有量は、例えば、感光層(電荷輸送層)の全固形分に対して、10質量%以上90質量%以下が好ましく、30質量%以上90質量%以下がより好ましく、50質量%以上90質量%以下が更に好ましい。

なお、全結着樹脂と電荷輸送材料との配合比(質量比=結着樹脂:電荷輸送材料)は10:1から1:5までが望ましい。

【0 2 5 5】

次に、フッ素含有樹脂粒子について説明する。

フッ素含有樹脂粒子としては、例えば、4フッ化エチレン樹脂、3フッ化塩化エチレン

50

樹脂、6フッ化プロピレン樹脂、フッ化ビニル樹脂、フッ化ビニリデン樹脂、2フッ化2塩化エチレン樹脂及びそれらの共重合体の粒子の中から1種又は2種以上を選択するのが望ましい。これらの中でも、フッ素含有樹脂粒子としては、特に、4フッ化エチレン樹脂粒子、フッ化ビニリデン樹脂粒子が望ましい。

【0256】

フッ素含有樹脂粒子の一次粒径は、0.05 μm 以上1 μm 以下であることがよく、望ましくは0.1 μm 以上0.5 μm 以下である。

なお、この一次粒子は、感光層（電荷輸送層）から試料片を得て、これをSEM（走査型電子顕微鏡）により例えば倍率5000倍以上で観察し、一次粒子状態のフッ素樹脂粒子の最大径を測定し、これを50個の粒子について行った平均値とする。なお、SEMとして日本電子製JSM-6700Fを使用し、加速電圧5kVの二次電子画像を観察する。

10

【0257】

フッ素樹脂粒子の市販品としては、例えば、ルプロン（登録商標）シリーズ（ダイキン工業株式会社製）、テフロン（登録商標）シリーズ（デュポン製）、ダイニオン（登録商標）シリーズ（住友3M製）等が挙げられる。

【0258】

フッ素含有樹脂粒子の含有量は、感光層（電荷輸送層）の全固形分に対して、1質量%以上30質量%以下が好ましく、3質量%以上20質量%以下がより好ましく、5質量%以上15質量%以下が更に好ましい。

20

【0259】

次に、フッ素含有分散剤について説明する。

フッ素含有分散剤としては、フッ化アルキル基を有する重合性化合物を単独重合又は共重合した重合体（以下「フッ化アルキル基含有重合体」とも称する）が挙げられる。

【0260】

フッ素含有分散剤として具体的には、フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートの単独重合体、フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートとフッ素原子を有さないモノマーとのランダム又はブロック共重合体等が挙げられる。なお、（メタ）アクリレートとは、アクリレートおよびメタクリレートの双方を意味する。

フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートとしては、例えば、2,2,2-トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレートが挙げられる。

30

フッ素原子を有さないモノマーとしては、例えば、（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、t-ブチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、2-メトキシエチル（メタ）アクリレート、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、2-エトキシエチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、4-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、フェノキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル o-フェニルフェノール（メタ）アクリレート、o-フェニルフェノールグリシジルエーテル（メタ）アクリレートが挙げられる。

40

【0261】

その他、フッ素含有分散剤として具体的には、米国特許5637142号明細書、特許第4251662号公報などに開示されたブロック又はブランチポリマーも挙げられる。更に、フッ素含有分散剤として具体的には、フッ素系界面活性剤も挙げられる。

50

【 0 2 6 2 】

これらの中でも、フッ素含有分散剤としては、下記一般式（ F A ）で示される構造単位を有するフッ化アルキル基含有重合体が好ましく、下記一般式（ F B ）で示される構造単位と、下記一般式（ F B ）で示される構造単位とを有するフッ化アルキル基含有重合体により好ましい。

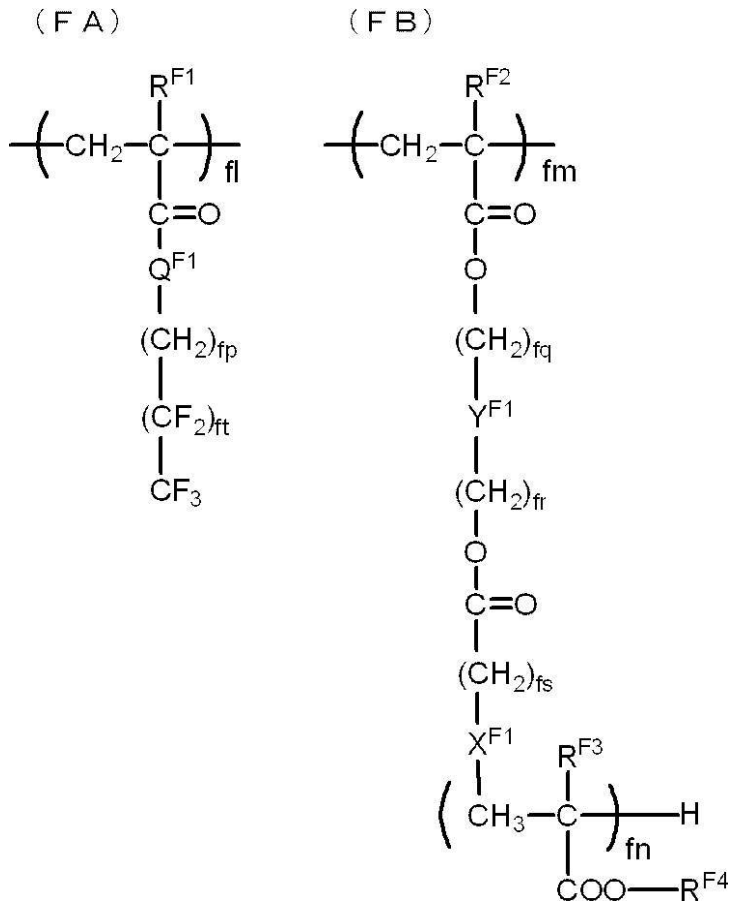
【 0 2 6 3 】

以下、下記一般式（ F A ）で示される構造単位と、下記一般式（ F B ）で示される構造単位とを有するフッ化アルキル基含有重合体について説明する。

【 0 2 6 4 】

【 化 2 2 】

10



20

30

【 0 2 6 5 】

一般式（ F A ）及び（ F B ）中、 $\text{R}^{\text{F}1}$ 、 $\text{R}^{\text{F}2}$ 、 $\text{R}^{\text{F}3}$ 及び $\text{R}^{\text{F}4}$ は、各々独立に、水素原子、又はアルキル基を表す。

$\text{X}^{\text{F}1}$ は、アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、又は単結合を表す。

40

$\text{Y}^{\text{F}1}$ は、アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖、 $-(\text{C}_{\text{fx}}\text{H}_{2\text{fx}-1}(\text{OH}))$ - 又は単結合を表す。

$\text{Q}^{\text{F}1}$ は、 $-\text{O}-$ 、又は $-\text{NH}-$ を表す。

fl 、 fm 及び fn は、各々独立に、1以上の整数を表す。

fp 、 fq 、 fr 及び fs は、各々独立に、0または1以上の整数を表す。

ft は、1以上7以下の整数を表す。

fx は1以上の整数を表す。

【 0 2 6 6 】

一般式（ F A ）及び（ F B ）中、 $\text{R}^{\text{F}1}$ 、 $\text{R}^{\text{F}2}$ 、 $\text{R}^{\text{F}3}$ 及び $\text{R}^{\text{F}4}$ を表す基としては、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基等が好ましく、水素原子、メチル基がより

50

好ましく、メチル基が更に好ましい。

【0267】

一般式 (F A) 及び (F B) 中、 X^{F1} 及び Y^{F1} を表すアルキレン鎖 (未置換アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖) としては、炭素数 1 以上 10 以下の直鎖状又は分岐状のアルキレン鎖が好ましい。

Y^{F1} を表す $-(C_{fx}H_{2fx-1}(OH))-$ 中の fx は、1 以上 10 以下の整数を表すことが好ましい。

fp 、 fq 、 fr 及び fs は、それぞれ独立に 0 または 1 以上 10 以下の整数を表すことが好ましい。

fn は、例えば、1 以上 60 以下が好ましい。

10

【0268】

ここで、フッ素含有分散剤において、一般式 (F A) で示される構造単位と一般式 (F B) で示される構造単位との比、つまり、 $f1 : fm$ は、1 : 9 から 9 : 1 までの範囲が好ましく、3 : 7 から 7 : 3 までの範囲がより好ましい。

【0269】

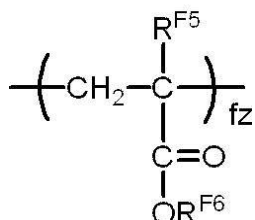
また、フッ素含有分散剤、一般式 (F A) で示される構造単位と一般式 (F B) で示される構造単位に加え、一般式 (F C) で示される構造単位を更に有していてもよい。一般式 (F C) で示される構造単位の含有比は、一般式 (F A) 及び (F B) で示される構造単位の合計、即ち $f1 + fm$ との比 ($f1 + fm : fz$) で、10 : 0 から 7 : 3 までの範囲が好ましく、9 : 1 から 7 : 3 までの範囲がより好ましい。

20

【0270】

【化23】

(F C)



30

【0271】

一般式 (F C) 中、 R^{F5} 、及び R^{F6} は、各々独立に、水素原子、又はアルキル基を表す。 fz は、1 以上の整数を表す。

【0272】

一般式 (F C) 中、 R^{F5} 、及び R^{F6} を表す基としては、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基等が好ましく、水素原子、メチル基がより好ましく、メチル基が更に好ましい。

【0273】

フッ素含有分散剤の市販品としては、例えば、GF300、GF400 (東亜合成社製)、サーフロンシリーズ (AGC セイメイケミカル社製)、フタージェントシリーズ (ネオス社製)、PF シリーズ (北村化学社製)、メガファックシリーズ (DIC 製)、FC シリーズ (3M 製) 等が挙げられる。

40

【0274】

フッ素含有分散剤の重量平均分子量は、例えば、2000 以上 250000 以下が好ましく、3000 以上 150000 以下がより好ましく、50000 以上 100000 以下が更に好ましい。

フッ素含有分散剤の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) により測定される値である。GPC による分子量測定は、例えば、測定装置として東

50

ソー製GPC・HLC-8120を用い、東ソー製カラム・TSK gel GMHHR-M+TSK gel GMHHR-M(7.8mm I.D. 30cm)を使用し、クロロホルム溶媒で行い、この測定結果から単分散ポリスチレン標準試料により作製した分子量校正曲線を使用して算出する。

【0275】

フッ化アルキル基含有共重合体の含有量は、例えば、フッ素含有樹脂粒子の質量に対して0.5質量%以上10質量%以下が好ましく、1質量%以上7質量%以下がより好ましい。

なお、フッ化アルキル基含有共重合体は、1種を単独でまたは2種以上を併用してもよい。

【0276】

電荷輸送層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0277】

電荷輸送層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた電荷輸送層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥、必要に応じて加熱することで行う。

【0278】

電荷輸送層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；塩化メチレン、クロロホルム、塩化エチレン等のハロゲン化脂肪族炭化水素類；テトラヒドロフラン、エチルエーテル等の環状又は直鎖状のエーテル類等の通常の有機溶剤が挙げられる。これら溶剤は、単独で又は2種以上混合して用いる。

【0279】

電荷輸送層形成用塗布液を電荷発生層の上に塗布する際の塗布方法としては、ブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0280】

電荷輸送層の膜厚は、例えば、好ましくは5μm以上50μm以下、より好ましくは10μm以上30μm以下の範囲内に設定される。

【0281】

(保護層)

保護層は、必要に応じて感光層上に設けられる。保護層は、例えば、帯電時の感光層の化学的变化を防止したり、感光層の機械的強度をさらに改善する目的で設けられる。

そのため、保護層は、硬化膜(架橋膜)で構成された層を適用することがよい。これら層としては、例えば、下記1)又は2)に示す層が挙げられる。

【0282】

1) 反応性基及び電荷輸送性骨格を同一分子内に有する反応性基含有電荷輸送材料を含む組成物の硬化膜で構成された層(つまり当該反応性基含有電荷輸送材料の重合体又は架橋体を含む層)

2) 非反応性の電荷輸送材料と、電荷輸送性骨格を有さず、反応性基を有する反応性基含有非電荷輸送材料と、を含む組成物の硬化膜で構成された層(つまり、非反応性の電荷輸送材料と、当該反応性基含有非電荷輸送材料の重合体又は架橋体と、を含む層)

【0283】

反応性基含有電荷輸送材料の反応性基としては、連鎖重合性基、エポキシ基、-OH、-OR[但し、Rはアルキル基を示す]、-NH₂、-SH、-COOH、-SiR^{Q1}_{3-Qn}(OR^{Q2})_{Qn}[但し、R^{Q1}は水素原子、アルキル基、又は置換若しくは無置換のアリール基を表し、R^{Q2}は水素原子、アルキル基、トリアルキルシリル基を表す。Qnは1~3の整数を表す]等の周知の反応性基が挙げられる。

【0284】

連鎖重合性基としては、ラジカル重合しうる官能基であれば特に限定されるものではな

10

20

30

40

50

く、例えば、少なくとも炭素二重結合を含有する基を有する官能基である。具体的には、ビニル基、ビニルエーテル基、ビニルチオエーテル基、スチリル基、ビニルフェニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、及びそれらの誘導体から選択される少なくとも一つを含有する基等が挙げられる。なかでも、その反応性に優れることから、連鎖重合性基としては、ビニル基、ビニルフェニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、及びそれらの誘導体から選択される少なくとも一つを含有する基であることが好ましい。

【0285】

反応性基含有電荷輸送材料の電荷輸送性骨格としては、電子写真感光体における公知の構造であれば特に限定されるものではなく、例えば、トリアリールアミン系化合物、ベンジジン系化合物、ヒドラゾン系化合物等の含窒素の正孔輸送性化合物に由来する骨格であって、窒素原子と共役している構造が挙げられる。これらの中でも、トリアリールアミン骨格が好ましい。

10

【0286】

これら反応性基及び電荷輸送性骨格を有する反応性基含有電荷輸送材料、非反応性の電荷輸送材料、反応性基含有非電荷輸送材料は、周知の材料から選択すればよい。

【0287】

保護層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0288】

保護層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた保護層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱等の硬化処理することで行う。

20

【0289】

保護層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶剤；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶剤；エチレングリコールモノメチルエーテル等のセロソルブ系溶剤；イソプロピルアルコール、ブタノール等のアルコール系溶剤等が挙げられる。これら溶剤は、単独で又は2種以上混合して用いる。

なお、保護層形成用塗布液は、無溶剤の塗布液であってもよい。

【0290】

保護層形成用塗布液を感光層（例えば電荷輸送層）上に塗布する方法としては、浸漬塗布法、突き上げ塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、ブレード塗布法、ナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

30

【0291】

保護層の膜厚は、例えば、好ましくは1 μm 以上20 μm 以下、より好ましくは2 μm 以上10 μm 以下の範囲内に設定される。

【0292】

（単層型感光層）

単層型感光層（電荷発生／電荷輸送層）は、例えば、電荷発生材料と電荷輸送材料と結着樹脂（BPポリカーボネート樹脂）と、必要に応じて、その他周知の添加剤と、を含む層である。なお、これら材料は、電荷発生層及び電荷輸送層で説明した材料と同様である。

40

そして、単層型感光層中、電荷発生材料の含有量は、全固形分に対して10質量%以上85質量%以下がよく、好ましくは20質量%以上50質量%以下である。

一方、単層型感光層中、電荷輸送材料、結着樹脂（BPポリカーボネート樹脂）、酸化防止剤および紫外線吸収剤の含有量は電荷輸送層中での含有量と同様である。

単層型感光層の形成方法は、電荷発生層や電荷輸送層の形成方法と同様である。

単層型感光層の膜厚は、例えば、5 μm 以上50 μm 以下がよく、好ましくは10 μm 以上40 μm 以下である。

【実施例】

50

【 0 2 9 3 】

以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。なお、以下の説明において、特に断りのない限り、「部」及び「%」はすべて質量基準である。

【 0 2 9 4 】

< 感光体の作製 >

[感光体 1]

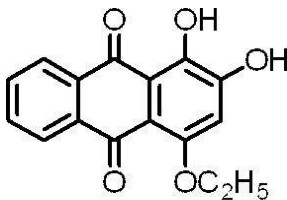
酸化亜鉛（商品名：MZ 300、テイカ株式会社製）100質量部、シランカップリング剤としてN-2-（アミノエチル）-3-アミノプロピルトリエトキシシランの10質量%のトルエン溶液を10質量部、トルエン200質量部を混合して攪拌を行い、2時間還流を行った。その後10mmHgにてトルエンを減圧留去し、135℃で2時間焼き付けて、シランカップリング剤による酸化亜鉛の表面処理を行った。

表面処理した酸化亜鉛：33質量部、ブロック化イソシアネート（商品名：スミジュール3175、住友バイエルンウレタン社製）：6質量部、下記構造式（AK-1）で示される化合物：1質量部、メチルエチルケトン：25質量部を30分間混合し、その後ブチラール樹脂（商品名：エスレックBM-1、積水化学工業社製）：5質量部、シリコーンボール（商品名：トスパール120、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製）：3質量部、レベリング剤としてシリコーンオイル（商品名：SH29PA、東レダウコーニングシリコーン社製）：0.01質量部を添加し、サンドミルにて3時間の分散を行い、下引層形成用塗布液を得た。

さらに、浸漬塗布法にて、下引層形成用塗布液を、直径47mm、長さ357mm、肉厚1mmのアルミニウム基材上に塗布し、180℃、30分の乾燥硬化を行い、膜厚25μmの下引層を得た。

【 0 2 9 5 】

【 化 2 4 】



（AK-1）

【 0 2 9 6 】

次に、電荷発生材料としてのヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料「Cuk 特性X線を用いたX線回折スペクトルのブラッグ角度（ $2\theta \pm 0.2^\circ$ ）が少なくとも 7.3° 、 16.0° 、 24.9° 、 28.0° の位置に回折ピークを有するV型のヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料（600nm以上900nm以下の波長域での分光吸収スペクトルにおける最大ピーク波長 = 820nm、平均粒径 = 0.12μm、最大粒径 = 0.2μm、比表面積値 = 60m²/g）」、結着樹脂としての塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂（商品名：VMCH、日本ユニカー社製）、およびn-酢酸ブチルからなる混合物を、容量100mLガラス瓶中に、充填率50%で1.0mmガラスビーズと共にに入れて、ペイントシェーカーを用いて2.5時間分散処理し、電荷発生層用塗布液を得た。ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂の混合物に対して、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の含有率を55.0体積%とし、分散液の固形分は6.0質量%とした。含有率は、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の比重を1.606g/cm³、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂の比重1.35g/cm³をとして計算した。

得られた電荷発生層形成用塗布液を、下引層上に浸漬塗布し、100℃で5分間乾燥して、膜厚0.20μmの電荷発生層を形成した。

【 0 2 9 7 】

次に、電荷輸送材料として、ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）「例示化合物（ＣＴ１－１）」８．０質量部およびベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）「例示化合物（ＣＴ２－１）」３２．０質量部と、結着樹脂として、ＢＰポリカーボネート樹脂「例示化合物（ＰＣ－１）」、 $p m : p n = 25 : 75$ 、粘度平均分子量＝５万」６０．０質量部と、フッ素含有樹脂粒子として、４フッ化エチレン樹脂粒子（体積平均粒子径２００ｎｍ）：８質量部と、フッ素含有分散剤として、ＧＦ４００（東亜合成社製：フッ化アルキル基を持つメタクリレートを少なくとも重合成分とした界面活性剤）：０．３質量部と、酸化防止剤として、ヒンダードフェノール系酸化防止剤「例示化合物（ＨＰ－１）」、分子量７７５」３．２質量部（全電荷輸送材料合計量１００質量％に対して８．０質量％）とを、テトラヒドロフラン３４０．０質量部に加えて溶解し、電荷輸送層形成用塗布液を得た。

10

得られた電荷輸送層形成用塗布液を、電荷発生層上に浸漬塗布し、１５０、４０分の乾燥を行うことにより、膜厚３４μｍの電荷輸送層を形成した。

【０２９８】

以上の工程を経て、感光体１を得た。

【０２９９】

[感光体２～４]

表１に従って、電荷輸送材料の種類と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類とを変更した以外は、感光体１と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３００】

[感光体５]

20

酸化防止剤としてのヒンダードフェノール系酸化防止剤に代えて、紫外線吸収剤として、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤「例示化合物（ＢＰ－１）」３．２質量部（全電荷輸送材料合計量１００質量％に対して８．０質量％）を使用した以外は、感光体１と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０１】

[感光体６～８]

表１に従って、電荷輸送材料の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体５と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０２】

[感光体９]

30

酸化防止剤として、ヒンダードフェノール系酸化防止剤「例示化合物（ＨＰ－１）」、分子量７７５」３．２質量部（全電荷輸送材料合計量１００質量％に対して８．０質量％）と共に、更に、紫外線吸収剤として、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤「例示化合物（ＢＰ－１）」３．２質量部（全電荷輸送材料合計量１００質量％に対して８．０質量％）を使用した以外は、感光体１と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０３】

[感光体１０]

表１に従って、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体９と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０４】

40

[感光体１１～２０]

表１に従って、電荷輸送材料の種類と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体９と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０５】

[感光体２１～２５]

表１に従って、酸化防止剤としてのヒンダードフェノール系酸化防止剤の量と、紫外線吸収剤としてのベンゾフェノン系紫外線吸収剤の量とを変更した以外は、感光体２０と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【０３０６】

50

〔感光体 26 ~ 31〕

表 2 に従って、電荷輸送材料として、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）「例示化合物（CT1-3）の量、およびベンジジン系電荷輸送材料（CT2）「例示化合物（CT2-2）」の量を変更した以外は、感光体 20 と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0307】

〔感光体 32 ~ 37〕

表 2 に従って、電荷輸送材料の種類と、酸化防止剤の種類と、紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体 9 と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0308】

〔感光体 38〕

B P ポリカーボネート樹脂に代えて、P C Z 5 0 0 「ビスフェノール Z 型ポリカーボネート樹脂（ビスフェノール Z の単独重合型ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量 5 万）」6 0 . 0 質量部を使用した以外は、感光体 32 と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0309】

< 実施例 1 >

得られた電子写真感光体（感光体 1）を電子写真方式の画像形成装置（富士ゼロックス社製：DocuCentre - IV C5570 改造機）に搭載し、この改造機を実施例 1 の画像形成装置とした。なお、改造機に搭載した帯電装置は、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加する接触型の重畳電圧印加方式の帯電装置とし、帯電条件は、交流電圧のピーク間電圧 2 . 3 k V、周波数 0 . 4 k H z、直流電圧は - 1 . 0 k V とした。また、帯電部材としては、帯電ロールを用いた。

【0310】

< 実施例 2 ~ 31 および比較例 1 ~ 7 >

感光体の種類、帯電条件を表 3、4 に従って変更した以外は実施例 1 と同様の画像形成装置（実施例 2 ~ 31 および比較例 1 ~ 7）とした。

【0311】

〔評価〕

各例の画像形成装置を用い、下記要領で、「焼付きゴースト」、「光疲労」、「ハーフトーン画像濃度」および「耐摩耗性」の評価を行った。

【0312】

（焼付きゴーストの評価）

各例の画像形成装置を用い、A 3 サイズの用紙に格子模様チャートを 3 0 0 0 枚連続出力した後、A 3 サイズの用紙に、画像濃度 2 0 % の全面ハーフトーン画像（C y a n 色の全面ハーフトーン画像）を 1 枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、格子模様の連続画像出力部と非連続画像出力部との濃度差について、目視による官能評価（グレード判定）を実施した。グレード判定は G 0 ~ G 5 まで 0 . 5 G 刻みで行い、G の数字が小さい程、濃度差が小さく、焼付きゴーストが発生していないことを示す。焼付きゴーストの許容グレードは G 3 . 5 以下である。なお、画像出力は全て 2 8 % R H の環境下で実施した。結果を表 3、表 4 に示す。

【0313】

（光疲労の評価）

まず、電子写真感光体（感光体 1 ~ 38）を各例の画像形成装置に搭載する前に、2 c m 四方の窓を開けた黒紙に巻き、窓開け部のみが光暴露されるようにして、白色蛍光灯（1 0 0 0 L u x）下で 1 0 分間放置し、電子写真感光体を光暴露させた。

次に、光暴露させた電子写真感光体を、各例の画像形成装置に搭載し、A 3 サイズの用紙に、画像濃度 5 0 % の全面ハーフトーン画像（C y a n）を 1 枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、光暴露部と非光暴露部との濃度差に

10

20

30

40

50

ついて、目視による官能評価（グレード判定）を実施した。グレード判定はG 0 ～ G 5 ま
で0.5 G刻みで行い、Gの数字が小さい程、濃度差が小さく、光疲労が発生していない
ことを示す。光疲労の許容グレードはG 3.5以下である。なお、画像出力は全て28
、85%RHの環境下で実施した。結果を表3、表4に示す。

【0314】

（ハーフトーン画像濃度の評価）

電子写真感光体（感光体1～38）を、各例の画像形成装置に搭載し、A3サイズの内
紙に、画像濃度50%の全面ハーフトーン画像（Cyan）を1枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、目的とする画像濃度が出力されてい
るかを調べた。なお、画像出力は全て28、85%RHの環境下で実施した。結果を表
3、表4に示す。

10

【0315】

（耐摩耗性評価）

電子写真感光体（感光体1～38）を、各例の画像形成装置に搭載し、A3サイズの内
紙に、画像濃度5%のチャートを20000枚連続出力した後、電子写真感光体（感光体
1～38）の感光層の膜厚を測定した。感光層の膜厚は、渦電流式膜厚測定装置（フィッ
シャー・インストルメンツ社製）を用いて測定した。そして、20000枚連続出力前後
の感光層の膜厚の差（ μm ）を求めた。結果を表3、表4に示す。

【0316】

各実施例および各比較例で用いた電子写真感光体の構成を表1、表2に示す。また、各
例の評価結果について、表3～表4に一覧にして示す。なお、表1、表2中、酸化防止剤
および紫外線吸収剤の「量（質量%）」の欄は、全電荷輸送材料合計量100質量%に
対する割合を示している。

20

【0317】

【表 1】

	電荷輸送材料				結着樹脂		酸化防止剤				紫外線吸収剤			
	(CT1)		(CT2)		例示化合物 No	pm/pn	例示化合物 No	分子量	量部数	質量%	例示化合物 No	量部数	質量%	
	例示化合物 No	量部数	例示化合物 No	量部数										
感光体 1	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 2	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 3	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 4	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 5	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 6	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 7	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 8	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 9	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 10	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 11	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 12	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 13	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 14	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 15	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 16	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 17	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 18	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 19	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 20	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0	
感光体 21	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	4.8	12.0	BP-3	4.8	12.0	
感光体 22	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	5.8	14.5	BP-3	5.8	14.5	
感光体 23	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	6.4	16.0	BP-3	6.4	16.0	
感光体 24	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	11.6	29.0	BP-3	11.6	28.9	
感光体 25	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	12.5	30.3	BP-3	12.5	30.1	

【 0 3 1 8 】

10

20

30

【表 2】

	電荷輸送材料				結着樹脂		酸化防止剤				紫外線吸収剤		
	(GT1)		(GT2)		例示化合物 No	pm/pn	例示化合物 No	分子量	量部数	量質量%	例示化合物 No	量部数	量質量%
	例示化合物 No	量部数	例示化合物 No	量部数									
感光体 26	CT1-3	16.0	CT2-2	24.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 27	CT1-3	20.0	CT2-2	20.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 28	CT1-3	24.0	CT2-2	16.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 29	CT1-3	4.0	CT2-2	36.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 30	CT1-3	24.0	CT2-2	19.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 31	CT1-3	36.0	CT2-2	4.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 32	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	無し	0	0
感光体 33	無し	0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HF-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 34	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-1	220	3.2	8.0	無し	0	0
感光体 35	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	CUA-1	3.2	8.0
感光体 36	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-1	220	3.2	8.0	CUA-1	3.2	8.0
感光体 37	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-2	—	3.2	8.0	無し	0	0
感光体 38	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PCZ500	—	無し	—	0	0	無し	0	0

【表 3】

	感光体 No.	帯電装置の設定				評価			
		電圧印加 方式	交流成分		直流成分 印加電圧	焼付き ゴースト	光疲労	ハートン 画像濃度	耐摩耗性
			ピーク間電圧	周波数					
実施例 1	感光体 1	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.2μm
実施例 2	感光体 2	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.2μm
実施例 3	感光体 3	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.2μm
実施例 4	感光体 4	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.2μm
実施例 5	感光体 5	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.1μm
実施例 6	感光体 6	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.1μm
実施例 7	感光体 7	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.1μm
実施例 8	感光体 8	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	3.5G	良好	1.1μm
実施例 9	感光体 9	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.5G	2.5G	良好	1.2μm
実施例 10	感光体 10	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.5G	3.0G	良好	1.2μm
実施例 11	感光体 11	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.5G	2.5G	良好	1.2μm
実施例 12	感光体 12	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.0G	3.0G	良好	1.1μm
実施例 13	感光体 13	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.0G	2.5G	良好	1.2μm
実施例 14	感光体 14	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.5G	2.0G	良好	1.2μm
実施例 15	感光体 15	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.5G	1.5G	良好	1.1μm
実施例 16	感光体 16	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.5G	1.0G	良好	1.2μm
実施例 17	感光体 17	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.5G	1.0G	良好	1.2μm
実施例 18	感光体 18	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.0G	0.5G	良好	1.2μm
実施例 19	感光体 19	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0.5G	0G	良好	1.2μm
実施例 20	感光体 20	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	良好	1.2μm
実施例 21	感光体 21	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	僅かに薄い	1.2μm
実施例 22	感光体 22	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	僅かに薄い	1.2μm
実施例 23	感光体 23	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	やや薄い	1.2μm
実施例 24	感光体 24	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	やや薄い	1.2μm
実施例 25	感光体 25	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	薄い	1.2μm

【 0 3 2 0 】

【表 4】

	感光体 No.	帯電装置の設定				評価			
		電圧印加 方式	交流成分		直流成分 印加電圧	焼付き ゴースト	光疲労	ハーフトーン 画像濃度	耐摩耗性
			ピーク間電圧	周波数					
実施例 26	感光体 26	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	良好	1.2μm
実施例 27	感光体 27	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.0G	0.5G	良好	1.2μm
実施例 28	感光体 28	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	1.0G	0.5G	良好	1.2μm
実施例 29	感光体 29	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	0G	0G	やや薄い	1.1μm
実施例 30	感光体 30	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	2.0G	1.5G	良好	1.1μm
実施例 31	感光体 31	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.0G	2.5G	良好	1.1μm
比較例 1	感光体 32	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	5.0G	5.0G	良好	1.1μm
比較例 2	感光体 33	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	判定不可	判定不可	濃度不良	1.0μm
比較例 3	感光体 34	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	5.0G	5.0G	良好	1.2μm
比較例 4	感光体 35	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	5.0G	5.0G	良好	1.1μm
比較例 5	感光体 36	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	5.0G	4.5G	良好	1.2μm
比較例 6	感光体 37	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	5.0G	5.0G	良好	1.2μm
比較例 7	感光体 38	重畳電圧	2.3kV	0.4kHz	-1.0kV	3.5G	5.0G	良好	3.0μm

10

20

30

40

【0321】

< 表 3、4 の説明 >

電圧印加方式；重畳電圧は重畳電圧印加方式を表す。

【0322】

上記結果から、本実施例では、比較例に比べ、「焼付きゴースト」および「光疲労」が抑制されていることがわかる。

また、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤の配合量が適切な実施例 1～20 は、実施例 21～25 に比べ、目的とするハーフトーン画像濃

50

度が得られていることがわかる。

また、本実施例では、比較例 7 に比べ、耐摩耗性が高いことがわかる。

【0323】

なお、表 1～表 2 の略称等の詳細は以下の通りである。

【0324】

- ・CT1-1：ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の例示化合物（CT1-1）
- ・CT1-2：ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の例示化合物（CT1-2）
- ・CT1-3：ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の例示化合物（CT1-3）

【0325】

- ・CT2-1：ベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の例示化合物（CT2-1）
- ・CT2-2：ベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の例示化合物（CT2-2）

10

【0326】

- ・PC-1：BPポリカーボネート樹脂の例示化合物（PC-1）
- ・PCZ500：ビスフェノール Z 型ポリカーボネート樹脂（ビスフェノール Z の単独重合型ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量 5 万）

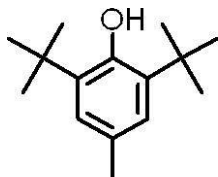
【0327】

- ・HP-1：ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物（HP-1）
- ・HP-2：ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物（HP-2）
- ・HP-3：ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物（HP-3）
- ・CAO-1：酸化防止剤の比較化合物（下記構造式（CAO-1）で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤参照）
- ・CAO-2：酸化防止剤の比較化合物（下記構造式（CAO-2）で示されるヒンダードアミン系酸化防止剤参照）

20

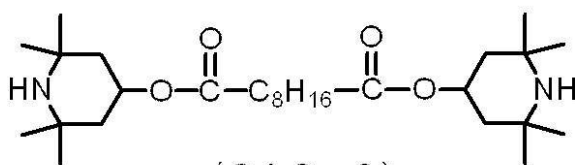
【0328】

【化 25】



(CAO-1)

30



(CAO-2)

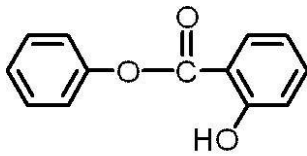
【0329】

- ・BP-1：ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物（BP-1）
- ・BP-2：ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物（BP-2）
- ・BP-3：ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物（BP-3）
- ・CUA-1：紫外線吸収剤の比較化合物（下記構造式（CUA-1）で示されるベンゾエート系紫外線吸収剤参照）

40

【0330】

【化 2 6】



(CUA-1)

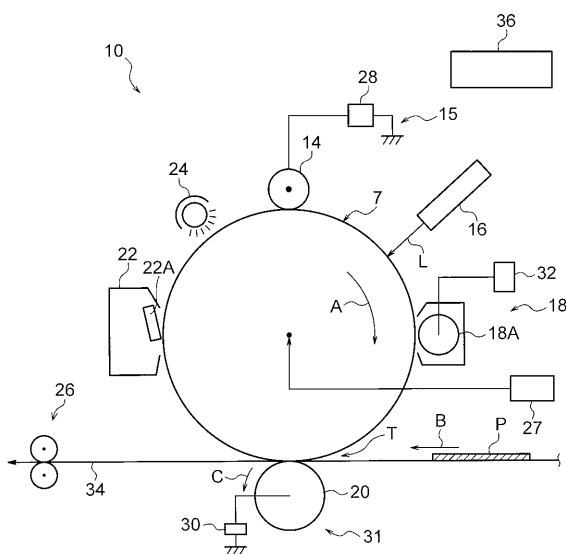
【符号の説明】

【0331】

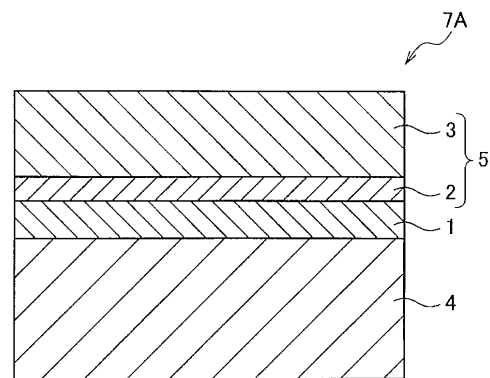
1 下引層、2 電荷発生層、3 電荷輸送層、4 導電性基体、7 A, 7 電子写真感光体、10 画像形成装置、14 帯電部材、15 帯電装置、16 静電潜像形成装置（露光装置）、18 現像装置、20 転写部材、22 清掃装置（クリーニング装置）、22 A 清掃ブレード（クリーニングブレード）、24 除電装置、26 定着装置、27 駆動部、28 電源、30 電源、31 転写装置

10

【図 1】



【図 2】



フロントページの続き

(72)発明者 橋本 考平

神奈川県海老名市本郷 2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内

(72)発明者 河合 剛志

神奈川県海老名市本郷 2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内

F ターム(参考) 2H068 AA13 AA14 AA16 AA17 AA19 AA20 BA12 BA13 BA39 BB20
BB26 BB31 FA18 FA27 FC01